

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-074533

(43)Date of publication of application : 16.03.1999

(51)Int.Cl.

H01L 29/786

H01L 21/336

G02F 1/136

G09F 9/00

(21)Application number : 09-242198

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 22.08.1997

(72)Inventor : INOUE SATOSHI  
SHIMODA TATSUYA

(30)Priority

Priority number : 08225643  
09193082

Priority date : 27.08.1996  
03.07.1997

Priority country : JP

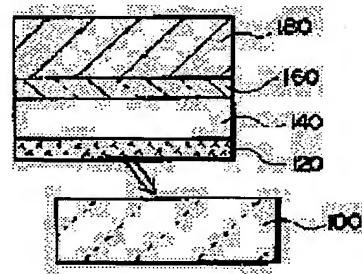
JP

(54) METHOD OF TRANSCRIBING THIN FILM DEVICE, THIN FILM DEVICE, THIN FILM INTEGRATED CIRCUIT DEVICE, ACTIVE MATRIX SUBSTRATE, AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new technology capable of independently and easily selecting a substrate used for manufacturing a thin film device or a substrate used for an actual operation of the thin film device and preventing a deterioration of characteristic of the thin film device.

SOLUTION: An amorphous silicon layer 120 to be a separation layer is formed on a highly reliable substrate 100 capable of transmitting laser beam, and a thin film device 140 such as TFT and the like is formed on the substrate. Laser beam irradiated from the substrate side causes abrasion in the separation layer. The thin film device is bonded to a transcription 180 through a bonding layer 160, and the substrate 100 is separated. A desirable thin film device can be transcribed to any substrate. A thickness of the separation layer is predetermined to the thickness causing abrasion when irradiated by the beam, approximately 10 nm.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than



the examiner's decision of rejection or  
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision  
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office



(19) 日本国特許庁 (J P)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-74533

(43) 公開日 平成11年(1999) 3月16日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

H 0 1 L 29/786

H 0 1 L 29/78

6 2 7 D

21/336

G 0 2 F 1/136

5 0 0

G 0 2 F 1/136

5 0 0

G 0 9 F 9/00

3 4 2 C

G 0 9 F 9/00

3 4 2

H 0 1 L 29/78

6 1 2 B

6 2 7 Z

審査請求 未請求 請求項の数16 F D (全 24 頁)

(21) 出願番号 特願平9-242198

(22) 出願日 平成9年(1997) 8月22日

(31) 優先権主張番号 特願平8-225643

(32) 優先日 平8(1996) 8月27日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(31) 優先権主張番号 特願平9-193082

(32) 優先日 平9(1997) 7月3日

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 井上 聡

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72) 発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

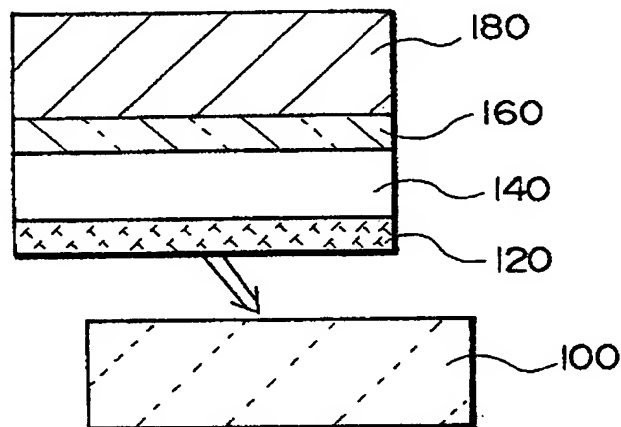
(74) 代理人 弁理士 井上 一 (外2名)

(54) 【発明の名称】 薄膜デバイスの転写方法、薄膜デバイス、薄膜集積回路装置、アクティブマトリクス基板および液晶表示装置

(57) 【要約】

【課題】 薄膜デバイスの製造時に使用する基板と、製品の実使用時に使用する基板とを、独立に自由に選択することができ、しかも、薄膜デバイスの特性を劣化させない新規な技術を提供することである。

【解決手段】 信頼性が高く、かつレーザー光が透過可能な基板(100)上に分離層となるアモルファスシリコン層(120)を設けておき、その基板上にTFT等の薄膜デバイス(140)を形成する。基板側からレーザー光を照射し、これによって分離層において剥離を生じせしめる。その薄膜デバイスを接着層(160)を介して転写体(180)に接合し、基板(100)を離脱させる。これにより、どのような基板にでも所望の薄膜デバイスを転写できる。分離層の膜厚は、光照射時にアブレーションを生ずる膜厚例えば10nm程度としておく。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上の薄膜デバイスを含む被転写層を転写体に転写する方法であって、

前記基板上にアモルファスシリコン層を形成する第 1 工程と、

前記アモルファスシリコン層上に前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を形成する第 2 工程と、

前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を接着層を介して前記転写体に接合する第 3 工程と、

前記基板を介して前記アモルファスシリコン層に光を照射し、前記アモルファスシリコン層の層内および／または界面において剥離を生じさせて、前記基板と前記被転写層との結合力を低下させる第 4 工程と、

前記基板を前記アモルファスシリコン層から離脱させる第 5 工程と、

を有し、

前記第 2 工程にて形成される前記被転写層は薄膜トランジスタを含み、前記第 1 工程にて形成される前記アモルファスシリコン層の膜厚は、前記第 2 工程にて形成される前記薄膜トランジスタのチャネル層の膜厚よりも薄く形成されることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 2】 基板上の薄膜デバイスを含む被転写層を転写体に転写する方法であって、

前記基板上に 25 nm 以下の膜厚にてアモルファスシリコン層を形成する第 1 工程と、

前記アモルファスシリコン層上に前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を形成する第 2 工程と、

前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を接着層を介して前記転写体に接合する第 3 工程と、

前記基板を介して前記アモルファスシリコン層に光を照射し、前記アモルファスシリコン層の層内および／または界面において剥離を生じさせて、前記基板と前記被転写層との結合力を低下させる第 4 工程と、

前記基板を前記アモルファスシリコン層から離脱させる第 5 工程と、

を有することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 3】 請求項 2 において、

前記第 2 工程では、前記アモルファスシリコン層の膜厚を、11 nm 以下の膜厚にて形成することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 4】 請求項 1 乃至 3 のいずれかにおいて、

前記第 2 工程では、低圧気相成長法にて前記アモルファスシリコン層を形成することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 5】 基板上の薄膜デバイスを含む被転写層を転写体に転写する方法であって、

前記基板上に、分離層を形成する工程と、

前記分離層上にシリコン系光吸収層を形成する工程と、

前記シリコン系光吸収層上に前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を形成する工程と、

前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を接着層を介して前記転写体に接合する工程と、

前記基板を介して前記分離層に光を照射し、前記分離層の層内および／または界面にて剥離を生じさせる工程と、

前記基板を前記分離層から離脱させる工程と、

を有することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 6】 請求項 5 において、

前記分離層及び前記光吸収層はアモルファスシリコンにて形成され、

前記分離層及び前記光吸収層間に、シリコン系の介在層を形成する工程をさらに設けたことを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 7】 基板上の薄膜デバイスを含む被転写層を転写体に転写する方法であって、

前記基板上に分離層を形成する第 1 工程と、

前記分離層上に前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を形成する第 2 工程と、

前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を接着層を介して前記転写体に接合する第 3 工程と、

前記基板を介して前記分離層に光を照射し、前記分離層の層内および／または界面にて剥離を生じさせる第 4 工程と、

前記基板を前記分離層から離脱させる第 5 工程と、

を有し、

前記第 4 工程では、前記分離層の層内および／または界面にて剥離を生じた際に前記分離層の上層に作用する応力を、前記分離層の上層が有する耐力により受けとめて、前記分離層の上層の変形または破壊を防止することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 8】 請求項 7 において、

前記第 4 工程の実施前に、前記分離層の上層となるいずれかの位置にて、前記耐力を確保するための補強層を形成する工程を、さらに有することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 9】 請求項 1 乃至 8 のいずれかにおいて、

請求項 1 乃至 8 のいずれかに記載の転写方法を複数回実行して、前記基板よりも大きい前記転写体上に、複数の被転写層を転写することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 10】 請求項 1 乃至 8 のいずれかにおいて、

請求項 1 乃至 8 のいずれかに記載の転写方法を複数回実行して、前記転写体上に、薄膜デバイスの設計ルールレベルが異なる複数の被転写層を転写することを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。

【請求項 11】 請求項 1 乃至 10 のいずれかに記載の転写方法を用いて前記転写体に転写されてなる薄膜デバイス。

【請求項 12】 請求項 11 において、

前記薄膜デバイスは、薄膜トランジスタ (TFT) であ

ることを特徴とする薄膜デバイス。

【請求項13】 請求項1乃至10のいずれかに記載の転写方法を用いて前記転写体に転写された薄膜デバイスを含んで構成される薄膜集積回路装置。

【請求項14】 マトリクス状に配置された薄膜トランジスタ(TFT)と、その薄膜トランジスタの一端に接続された画素電極とを含んで画素部が構成されるアクティブマトリクス基板であって、

請求項1乃至10のいずれかに記載の方法を用いて前記画素部の薄膜トランジスタを転写することにより製造されたアクティブマトリクス基板。

【請求項15】 マトリクス状に配置された走査線と信号線とに接続される薄膜トランジスタ(TFT)と、その薄膜トランジスタの一端に接続された画素電極とを含んで画素部が構成され、かつ、前記走査線および前記信号線に信号を供給するためのドライバ回路を内蔵するアクティブマトリクス基板であって、

請求項10に記載の方法を用いて形成された、第1の設計ルールレベルの前記画素部の薄膜トランジスタおよび第2の設計ルールレベルの前記ドライバ回路を構成する薄膜トランジスタを具備するアクティブマトリクス基板。

【請求項16】 請求項14又は15に記載のアクティブマトリクス基板を用いて製造された液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜デバイスの転写方法、薄膜デバイス、薄膜集積回路装置、アクティブマトリクス基板および液晶表示装置に関する。

【0002】

【背景技術】例えば、薄膜トランジスタ(TFT)を用いた液晶ディスプレイを製造するに際しては、基板上に薄膜トランジスタをCVD等により形成する工程を経る。薄膜トランジスタを基板上に形成する工程は高温処理を伴うため、基板は耐熱性に優れる材質のもの、すなわち、軟化点および融点が高いものを使用する必要がある。そのため、現在では、1000℃程度の温度に耐える基板としては石英ガラスが使用され、500℃前後の温度に耐える基板としては耐熱ガラスが使用されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】上述のように、薄膜デバイスを搭載する基板は、それらの薄膜デバイスを製造するための条件を満足するものでなければならない。つまり、使用する基板は、搭載されるデバイスの製造条件を必ず満たすように決定される。

【0004】しかし、TFT等の薄膜デバイスを搭載した基板が完成した後の段階のみに着目すると、上述の「基板」が必ずしも好ましくないこともある。

【0005】例えば、上述のように、高温処理を伴う製

造プロセスを経る場合には、石英基板や耐熱ガラス基板等が用いられるが、これらは非常に高価であり、したがって製品価格の上昇を招く。

【0006】また、ガラス基板は重く、割れやすいという性質をもつ。パームトップコンピュータや携帯電話機等の携帯用電子機器に使用される液晶ディスプレイでは、可能な限り安価で、軽くて、多少の変形にも耐え、かつ落としても壊れにくいのが望ましいが、現実には、ガラス基板は重く、変形に弱く、かつ落下による破壊の恐れがあるのが普通である。

【0007】つまり、製造条件からくる制約と製品に要求される好ましい特性との間に溝があり、これら双方の条件や特性を満足させることは極めて困難であった。

【0008】そこで本発明者等は、薄膜デバイスを含む被転写層を従来のプロセスにて第1の基板上に形成した後に、この薄膜デバイスを含む被転写層を第1の基板から離脱させて、第2の基板に転写させる技術を提案している(特願平8-225643号)。このために、第1の基板と被転写層である薄膜デバイスとの間に、分離層を形成している。この分離層に光を照射することで、分離層の層内および/または界面を剥離させて、第1の基板と被転写層との結合力を弱めることで、被転写層を第1の基板から離脱させることを可能としている。

【0009】ここで、本発明者のさらなる解析によると、分離層に光を照射する際に、その光エネルギーを過度に高めると、分離層に剥離を生じさせるに足るエネルギー以上の光が、分離層から漏れて、被転写層の薄膜デバイスに入射することが判明した。この光漏れにより、第2の基板に転写された薄膜デバイスの特性例えば電気的特性が、第1の基板に形成された薄膜デバイスと比較して劣化する場合が生ずることが判明した。

【0010】この劣化する特性としては、例えば薄膜デバイスとしてTFTを形成した場合、分離層に光を照射する工程において、照射した光がチャネル層にダメージを与え、オン電流の減少、オフ電流の増大を引き起こし、最悪の場合には、TFTを破壊してしまうことを突き止めた。

【0011】さらには、本発明者等の実験によれば、分離層の層内および/または界面に剥離を生じさせる工程にて、薄膜デバイスを含む被転写層が変形または破壊されることがあった。

【0012】本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、薄膜デバイスの製造時に使用する第1の基板と、例えば製品の実使用時に使用する第2の基板(製品の用途からみて好ましい性質をもった基板)とを、独立に自由に選択することを可能とし、かつ、分離層に照射される光エネルギーを低減させて、第2の基板に転写された薄膜デバイスの特性を劣化させることがない新規な技術を提供することにある。

【0013】本発明の他の目的は、たとえ分離層から光

10

20

30

40

50

5

漏れがあったとしても、薄膜デバイスにその漏れた光が到達せず、しかも、確立された薄膜形成技術を利用して品質の高い薄膜デバイスを形成することができる新規な技術を提供することにある。

【0014】本発明のさらに他の目的は、分離層の層内および／または界面に剥離を生じさせる工程にて、薄膜デバイスを含む被転写層が変形または破壊されることを確実に防止して、第2の基板に薄膜デバイスを転写することができる新規な技術を提供することにある。

【0015】

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する本発明は、以下のような構成をしている。

【0016】請求項1に記載の発明は、基板上の薄膜デバイスを含む被転写層を転写体に転写する方法であって、前記基板上にアモルファスシリコン層を形成する第1工程と、前記アモルファスシリコン層上に前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を形成する第2工程と、前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を接着層を介して前記転写体に接合する第3工程と、前記基板を介して前記アモルファスシリコン層に光を照射し、前記アモルファスシリコン層の層内および／または界面において剥離を生じさせて、前記基板と前記被転写層との結合力を低下させる第4工程と、前記基板を前記アモルファスシリコン層から離脱させる第5工程と、を有し、前記第2工程にて形成される前記被転写層は薄膜トランジスタを含み、前記第1工程にて形成される前記アモルファスシリコン層の膜厚は、前記第2工程にて形成される前記薄膜トランジスタのチャンネル層の膜厚よりも薄く形成されることを特徴とする。

【0017】デバイス製造における信頼性が高い例えば石英基板などの基板上に、例えば、光を吸収する特性をもつ分離層を設けておき、その基板上にTFT等の薄膜デバイスを形成する。次に、特に限定されないが、例えば接着層を介して薄膜デバイスを所望の転写体に接合し、その後分離層に光を照射し、これによって、その分離層において剥離現象を生じせしめて、その分離層と前記基板との間の密着性を低下させる。そして、基板に力を加えてその基板を薄膜デバイスから離脱させる。これにより、どのような転写体にも、所望の、信頼性の高いデバイスを転写（形成）できることになる。

【0018】ここで、請求項1の発明では第1工程にて基板上に形成され、第4工程にて光照射により剥離を生ずる層として、アモルファスシリコン層を用いている。このアモルファスシリコン層は、図31に示すように、膜厚が薄くなるほど、該アモルファスシリコン層に光照射されて剥離（図31ではアブレーションと称している）を生じさせるに必要な光エネルギーを小さくできる。

【0019】ここで、第2工程にて形成される被転写層は、薄膜デバイスとして薄膜トランジスタを含んでお

6

り、そのチャンネル層はポリシリコンあるいはアモルファスシリコンなどのシリコン層にて形成され、一般に25nmを越える例えば50nm程度の膜厚にて形成される。請求項1の発明では、第1工程にて形成される分離層（アブレーション層）としてのアモルファスシリコンの膜厚を、被転写層中の薄膜トランジスタのチャンネル層よりも薄く形成している。従って、光照射工程での消費エネルギーが低減すると共に、それに用いる光源装置の小型化が図れる。さらには、照射される光エネルギーが少ないために、万一アモルファスシリコン層から光漏れして、その漏れた光が薄膜デバイスに入射しても、光エネルギーが少ない分だけ薄膜デバイスの特性の劣化が低減する。

【0020】請求項2の発明は、請求項1の発明でのアモルファスシリコン層の膜厚の定義に代えて、該層の膜厚を25nm以下と定義したものである。

【0021】上述した通り、アモルファスシリコン層は、図31に示すように、膜厚が薄くなるほど、該アモルファスシリコン層に光照射されて剥離を生じさせるに必要な光エネルギーを小さくでき、請求項2にて定義した膜厚であれば、光エネルギーを十分小さくできる。なお、アモルファスシリコン層の膜厚範囲は、5～25nmとすることが好ましく、さらに好ましくは15nm以下、あるいは請求項3に示すように11nm以下とすると、アモルファスシリコン層に光照射されて剥離を生じさせるに必要な光エネルギーをさらに小さくできる。

【0022】請求項4の発明は、請求項1乃至3のいずれかにおいて、前記第2工程では、低圧気相成長法（LP-CVD）にて前記アモルファスシリコン層を形成することを特徴とする。

【0023】LP-CVDにてアモルファスシリコン層を形成すると、プラズマCVD、大気圧（AP）CVD、ECRなどと比較して、密着性が高く、前記薄膜デバイスを含む被転写層を形成する際に、水素が発生し、膜剥がれ等の不良が発生する危険が少ない。

【0024】請求項5の発明は、基板上の薄膜デバイスを含む被転写層を転写体に転写する方法であって、前記基板上に、分離層を形成する工程と、前記分離層上にシリコン系光吸収層を形成する工程と、前記シリコン系光吸収層上に前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を形成する工程と、前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を接着層を介して前記転写体に接合する工程と、前記基板を介して前記分離層に光を照射し、前記分離層の層内および／または界面にて剥離を生じさせる工程と、前記基板を前記分離層から離脱させる工程と、を有することを特徴とする。

【0025】請求項5の発明によれば、万一分離層から光漏れしても、その漏れた光は、薄膜デバイスに入射する前に、シリコン系光吸収層に吸収される。従って、薄膜デバイスに光が入射することを確実に防止でき、光入

10

20

30

40

50



射に起因した薄膜デバイスの特性の劣化を防止できる。しかも、薄膜デバイスを含む被転写層は、シリコン系光吸収層上に形成できる。このため、光反射効果を有する金属層上に被転写層を形成する場合のように、金属汚染の虞がなく、従来より確立されているシリコン上への薄膜形成技術を利用して、薄膜デバイスを形成することができる。

【0026】請求項6の発明は、請求項5において、前記分離層及び前記光吸収層はアモルファスシリコンにて形成され、前記分離層及び前記光吸収層間に、シリコン系の介在層を形成する工程をさらに設けたことを特徴とする。

【0027】請求項6の発明によれば、図31で示したように、照射された光を吸収して、その光エネルギーが所定値以上となったときに剥離するアモルファスシリコン層を、分離層及びシリコン系光吸収層として用いている。この2層のアモルファスシリコン層を分離するための介在層としてシリコン系例えばシリコン酸化物を用いている。

【0028】請求項7の発明は、基板上の薄膜デバイスを含む被転写層を転写体に転写する方法であって、前記基板上に分離層を形成する第1工程と、前記分離層上に前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を形成する第2工程と、前記薄膜デバイスを含む前記被転写層を接着層を介して前記転写体に接合する第3工程と、前記基板を介して前記分離層に光を照射し、前記分離層の層内および／または界面にて剥離を生じさせる第4工程と、前記基板を前記分離層から離脱させる第5工程と、を有し、前記第4工程では、前記分離層の層内および／または界面にて剥離を生じた際に前記分離層の上層に作用する応力を、前記分離層の上層が有する耐力により受けとめて、前記分離層の上層の変形または破壊を防止することを特徴とする。

【0029】この第4工程にて光照射すると、分離層を構成する物質が光化学的または熱的に励起され、その表面や内部の分子または原子の結合が切断されて、該分子または原子が外部に放出される。この現象は、主に、分離層を構成する物質の全部または一部が熔融、蒸散（気化）などの相変化を生ずる現象として現れる。このとき、上記の分子または原子の放出に伴い、分離層の上層に応力が作用する。

【0030】しかしこの応力は、分離層の上層が有する耐力により受けとめられ、分離層の上層の変形または破壊が防止される。

【0031】このような耐力を考慮して、分離層の上層を構成する構成層の材質および／または厚さを設計すればよい。例えば接着層の厚さ、被転写層の厚さ、転写体の材質及び厚さのうちの、一つまたは複数が上記耐力を考慮して設定される。

【0032】請求項8の発明は、請求項7において、前

記第4工程の実施前に、前記分離層の上層となるいずれかの位置にて、前記耐力を確保するための補強層を形成する工程を、さらに有することを特徴とする。

【0033】請求項8の発明では、分離層の上層を構成する最小限の構成層である接着層、被転写層及び転写体のみでは、上記の耐力を確保できないときに、補強層を追加することで、薄膜デバイスの変形、破壊を防止できる。

【0034】なお、請求項1～8の発明において、接着層を介して薄膜デバイス（薄膜デバイスを含む被転写層）を転写体に接合する工程と、基板を薄膜デバイスから離脱させる工程とは、その順序を問わず、いずれが先でもかまわない。但し、基板を離脱させた後の薄膜デバイス（薄膜デバイスを含む被転写層）のハンドリングに問題がある場合には、まず、薄膜デバイスを転写体に接合する工程を実施し、その後に基板を離脱させる工程を実施するのが望ましい。

【0035】また、薄膜デバイスの転写体への接合に用いられる接着層として、例えば、平坦化作用をもつ物質（例えば、熱硬化性樹脂）を用いれば、薄膜デバイスを含む被転写層の表面に多少の段差が生じていたとしても、その段差は平坦化されて無視できるようになり、よって常に良好な転写体への接合が可能となり、便利である。

【0036】前記転写体に付着している前記分離層を除去する工程を、さらに有することが好ましい。

【0037】不要な分離層を完全に除去するものである。

【0038】ここで、転写体の好まし材質、特性などについて言及すれば、まず前記転写体は、透明基板であることが好ましい。

【0039】この透明基板として、例えば、ソーダガラス基板等の安価な基板や、可撓性を有する透明なプラスチックフィルム等を挙げることができる。透明基板とすれば、例えば薄膜デバイスがTFTであれば、これが転写された転写体を液晶パネル用の基板として利用できる。

【0040】また、前記転写体は、被転写層の形成の際の最高温度を $T_{\text{m}}$ としたとき、ガラス転移点（ $T_g$ ）または軟化点が前記 $T_{\text{m}}$ 以下の材料で構成されていることが好ましい。

【0041】デバイス製造時の最高温度に耐えられず、従来は使用できなかった安価なガラス基板等を、自由に使用できるようになるからである。

【0042】本発明によれば、前記転写体は、ガラス転移点（ $T_g$ ）または軟化点が、前記薄膜デバイスの形成プロセスの最高温度以下であってもよく、なぜなら、薄膜デバイスの形成時に転写体はその最高温度に晒されることがないからである。

【0043】前記転写体は、合成樹脂またはガラス材で

構成することができる。

【0044】例えば、プラスチックフィルム等の撓み性（可撓性）を有する合成樹脂板に薄膜デバイスを転写すれば、剛性の高いガラス基板では得られないような優れた特性が実現可能である。本発明を液晶表示装置に適用すれば、しなやかで、軽くかつ落下にも強いディスプレイ装置が実現する。

【0045】また、例えば、ソーダガラス基板等の安価な基板も転写体として使用できる。ソーダガラス基板は低価格であり、経済的に有利な基板である。ソーダガラス基板は、TFT製造時の熱処理によりアルカリ成分が溶出するといった問題があり、従来は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置への適用が困難であった。しかし、本発明によれば、すでに完成した薄膜デバイスを転写するため、上述の熱処理に伴う問題は解消される。よってアクティブマトリクス型の液晶表示装置の分野において、ソーダガラス基板等の従来問題があった基板も使用可能となる。

【0046】次に、分離層及び被転写層が形成される基板の材質、特性などについて言及すれば、前記透光性基板は耐熱性を有することが好ましい。

【0047】薄膜デバイスの製造時に所望の高温処理が可能となり、信頼性が高く高性能の薄膜デバイスを製造することができるからである。

【0048】また、前記基板は、310nmの光を10%以上透過することが好ましい。このとき、前記光照射工程では、310nmの波長を含む光を照射する。

【0049】分離層においてアブレーションを生じさせるに足る光エネルギーを、基板を介して効率よく行うものである。

【0050】次に、分離層の好ましい材質、特性などについて説明すると、前記分離層は、アモルファスシリコンで構成されていることが好ましい。

【0051】アモルファスシリコンは光を吸収し、また、その製造も容易であり、実用性が高い。

【0052】さらには、前記アモルファスシリコンは、水素（H）を2原子%以上含有することが好ましい。

【0053】水素を含むアモルファスシリコンを用いた場合、光の照射に伴い水素が放出され、これによって分離層内に内圧が生じて、分離層における剥離を促す作用がある。

【0054】あるいは、前記アモルファスシリコンは、水素（H）を10原子%以上含有することができる。

【0055】水素の含有率が増えることにより、分離層における剥離を促す作用がより顕著になる。

【0056】分離層の他の材質として、窒化シリコンを挙げることができる。

【0057】分離層のさらに他の材質として、水素含有合金を挙げることができる。

【0058】分離層として水素含有合金を用いると、光

の照射に伴い水素が放出され、これによって分離層における剥離が促進される。

【0059】分離層のさらに他の材質として、窒素含有金属合金を挙げることができる。

【0060】分離層として窒素含有合金を用いると、光の照射に伴い窒素が放出され、これによって分離層における剥離が促進される。

【0061】この分離層は、多層膜とすることもできる。

【0062】単層膜に限定されないことを明らかなとしたものである。

【0063】この多層膜は、アモルファスシリコン膜とその上に形成された金属膜とから構成することができる。

【0064】分離層のさらに他の材質として、セラミックス、金属、有機高分子材料の少なくとも一種から構成することができる。

【0065】分離層として実際に使用可能なものをまとめて例示したものである。金属としては、例えば、水素含有合金や窒素含有合金も使用可能である。この場合、アモルファスシリコンの場合と同様に、光の照射に伴う水素ガスや窒素ガスの放出によって、分離層における剥離が促進される。

【0066】次に、光照射工程にて用いる光について説明すると、レーザー光を用いることが好ましい。

【0067】レーザー光はコヒーレント光であり、分離層内において剥離を生じさせるのに適する。

【0068】このレーザー光は、その波長を、100nm～350nmとすることができる。

【0069】短波長で光エネルギーのレーザー光を用いることにより、分離層における剥離を効果的に行うことができる。

【0070】上述の条件を満たすレーザーとしては、例えば、エキシマレーザーがある。エキシマレーザーは、短波長紫外域の高エネルギーのレーザー光出力が可能なガスレーザーであり、レーザー媒質として希ガス（Ar, Kr, Xe）とハロゲンガス（F<sub>2</sub>, HCl）とを組み合わせたものを用いることにより、代表的な4種類の波長のレーザー光を出力することができる（XeF=351nm, XeCl=308nm, KrF=248nm, ArF=193nm）。

【0071】エキシマレーザー光の照射により、基板上に設けられている分離層において、熱影響のない分子結合の直接の切断やガスの蒸発等の作用を生じせしめることができる。

【0072】レーザー光の波長としては、350nm～1200nmを採用することもできる。

【0073】分離層において、例えばガス放出、気化、昇華等の相変化を起こさせて分離特性を与える場合には、波長が350nm～1200nm程度のレーザー光

も使用可能である。

【0074】次に、薄膜デバイスについて説明すると、前記薄膜デバイスを薄膜トランジスタ（TFT）とすることができる。

【0075】高性能なTFTを、所望の転写体上に自由に転写（形成）できる。よって、種々の電子回路をその転写体上に搭載することも可能となる。

【0076】請求項9に記載の発明は、請求項1乃至8のいずれかにおいて、請求項1乃至8のいずれかに記載の転写方法を複数回実行して、前記透光性基板よりも大きい前記転写体上に、複数の被転写層を転写することを特徴とする。

【0077】信頼性の高い基板を繰り返し使用し、あるいは複数の基板を使用して薄膜パターンの転写を複数回実行することにより、信頼性の高い薄膜デバイスを搭載した大規模な回路基板を作成できる。

【0078】請求項10に記載の発明は、請求項1乃至8のいずれかにおいて、請求項1乃至8のいずれかに記載の転写方法を複数回実行して、前記転写体上に、薄膜デバイスの設計ルールレベルが異なる複数の被転写層を転写することを特徴とする。

【0079】一つの基板上に、例えば、種類の異なる複数の回路（機能ブロック等も含む）を搭載する場合、それぞれの回路に要求される特性に応じて、各回路毎に使用する素子や配線のサイズ（設計ルール、すなわちデザインルールと呼ばれるもの）が異なる場合がある。このような場合にも、本発明の転写方法を用いて、各回路毎に転写を実行していけば、設計ルールレベルの異なる複数の回路を一つの基板上に実現できる。

【0080】請求項11に記載の発明は、請求項1乃至10のいずれかに記載の転写方法を用いて前記転写体に転写されてなる薄膜デバイスである。

【0081】本発明の薄膜デバイスの転写技術（薄膜構造の転写技術）を用いて、任意の基板上に形成される薄膜デバイスであり、分離層を剥離するための光照射工程の改善により、その薄膜デバイスの特性が劣化することを防止又は低減できる。

【0082】請求項12に記載の発明は、請求項11において、前記薄膜デバイスは、薄膜トランジスタ（TFT）であることを特徴とする。

【0083】請求項13に記載の発明は、請求項1乃至10のいずれかに記載の転写方法を用いて前記転写体に転写された薄膜デバイスを含んで構成される薄膜集積回路装置である。

【0084】例えば、合成樹脂基板上に、薄膜トランジスタ（TFT）を用いて構成されたシングルチップマイクロコンピュータ等を搭載することも可能である。

【0085】請求項14に記載の発明は、マトリクス状に配置された薄膜トランジスタ（TFT）と、その薄膜トランジスタの一端に接続された画素電極とを含んで画

素部が構成されるアクティブマトリクス基板であって、請求項1乃至10のいずれかに記載の方法を用いて前記画素部の薄膜トランジスタを転写することにより製造されたアクティブマトリクス基板である。

【0086】本発明の薄膜デバイスの転写技術（薄膜構造の転写技術）を用いて、所望の基板上に画素部を形成してなるアクティブマトリクス基板である。製造条件からくる制約を排して自由に基板を選択できるため、従来にはない新規なアクティブマトリクス基板を実現することも可能である。

【0087】請求項15に記載の発明は、マトリクス状に配置された走査線と信号線とに接続される薄膜トランジスタ（TFT）と、その薄膜トランジスタの一端に接続された画素電極とを含んで画素部が構成され、かつ、前記走査線および前記信号線に信号を供給するためのドライバ回路を内蔵するアクティブマトリクス基板であって、請求項10に記載の方法を用いて形成された、第1の設計ルールレベルの前記画素部の薄膜トランジスタおよび第2の設計ルールレベルの前記ドライバ回路を構成する薄膜トランジスタを具備するアクティブマトリクス基板である。

【0088】アクティブマトリクス基板上に、画素部のみならずドライバ回路も搭載し、しかも、ドライバ回路の設計ルールレベルと画素部の設計ルールレベルとが異なるアクティブマトリクス基板である。例えば、ドライバ回路の薄膜パターンを、シリコンTFTの製造装置を利用して形成すれば、集積度を向上させることが可能である。

【0089】請求項16に記載の発明は、請求項14又は15に記載のアクティブマトリクス基板を用いて製造された液晶表示装置である。

【0090】例えば、プラスチック基板を用いた、しなやかに曲がる性質をもった液晶表示装置も実現可能である。

【0091】

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0092】（第1の実施の形態）図1～図6は本発明の第1の実施の形態（薄膜デバイスの転写方法）を説明するための図である。

【0093】[工程1]図1に示すように、基板100上に分離層（光吸収層）120を形成する。

【0094】以下、基板100および分離層120について説明する。

【0095】①基板100についての説明

基板100は、光が透過し得る透光性を有するものであるのが好ましい。

【0096】この場合、光の透過率は10%以上であるのが好ましく、50%以上であるのがより好ましい。この透過率が低過ぎると、光の減衰（ロス）が大きくな

り、分離層120を剥離するのにより大きな光量を必要とする。

【0097】また、基板100は、信頼性の高い材料で構成されているのが好ましく、特に、耐熱性に優れた材料で構成されているのが好ましい。その理由は、例えば後述する被転写層140や中間層142を形成する際に、その種類や形成方法によってはプロセス温度が高くなる(例えば350~1000℃程度)ことがあるが、その場合でも、基板100が耐熱性に優れていれば、基板100上への被転写層140等の形成に際し、その温度条件等の成膜条件の設定の幅が広がるからである。

【0098】従って、基板100は、被転写層140の形成の際の最高温度を $T_{max}$ としたとき、歪点が $T_{max}$ 以上の材料で構成されているのが好ましい。具体的には、基板100の構成材料は、歪点が350℃以上のものが好ましく、500℃以上のものがより好ましい。このようなものとしては、例えば、石英ガラス、コーニング7059、日本電気ガラスOA-2等の耐熱性ガラスが挙げられる。

【0099】また、基板100の厚さは、特に限定されないが、通常は、0.1~5.0mm程度であるのが好ましく、0.5~1.5mm程度であるのがより好ましい。基板100の厚さが薄すぎると強度の低下を招き、厚すぎると、基板100の透過率が低い場合に、光の減衰を生じ易くなる。なお、基板100の光の透過率が高い場合には、その厚さは、前記上限値を超えるものであってもよい。なお、光を均一に照射できるように、基板100の厚さは、均一であるのが好ましい。

#### 【0100】②分離層120の説明

分離層120は、照射される光を吸収し、その層内および/または界面において剥離(以下、「層内剥離」、「界面剥離」と言う)を生じるような性質を有するものであり、好ましくは、光の照射により、分離層120を構成する物質の原子間または分子間の結合力が消失または減少すること、すなわち、アブレーションが生じて層内剥離および/または界面剥離に至るものがよい。

【0101】さらに、光の照射により、分離層120から気体が放出され、分離効果が発現される場合もある。すなわち、分離層120に含有されていた成分が気体となって放出される場合と、分離層120が光を吸収して一瞬気体になり、その蒸気が放出され、分離に寄与する場合とがある。このような分離層120の組成としては、例えば、次のA~Eに記載されるものが挙げられる。

#### 【0102】A. アモルファスシリコン(a-Si)

このアモルファスシリコン中には、水素(H)が含有されていてもよい。この場合、Hの含有量は、2原子%以上程度であるのが好ましく、2~20原子%程度であるのがより好ましい。このように、水素(H)が所定量含有されていると、光の照射によって水素が放出され、分

離層120に内圧が発生し、それが上下の薄膜を剥離する力となる。アモルファスシリコン中の水素(H)の含有量は、成膜条件、例えばCVDにおけるガス組成、ガス圧、ガス雰囲気、ガス流量、温度、基板温度、投入パワー等の条件を適宜設定することにより調整することができる。

【0103】B. 酸化ケイ素又はケイ酸化合物、酸化チタンまたはチタン酸化合物、酸化ジルコニウムまたはジルコン酸化合物、酸化ランタンまたはランタン酸化合物等の各種酸化物セラミックス、透電体(強誘電体)あるいは半導体

酸化ケイ素としては、 $SiO$ 、 $SiO_2$ 、 $Si_3O_2$ が挙げられ、ケイ酸化合物としては、例えば $K_2SiO_3$ 、 $Li_2SiO_3$ 、 $CaSiO_3$ 、 $ZrSiO_4$ 、 $Na_2SiO_3$ が挙げられる。

【0104】酸化チタンとしては、 $TiO$ 、 $Ti_2O_3$ 、 $TiO_2$ が挙げられ、チタン酸化合物としては、例えば、 $BaTiO_4$ 、 $BaTiO_3$ 、 $Ba_2Ti_9O_{20}$ 、 $BaTi_5O_{11}$ 、 $CaTiO_3$ 、 $SrTiO_3$ 、 $PbTiO_3$ 、 $MgTiO_3$ 、 $ZrTiO_2$ 、 $SnTiO_4$ 、 $Al_2TiO_5$ 、 $FeTiO_3$ が挙げられる。

【0105】酸化ジルコニウムとしては、 $ZrO_2$ が挙げられ、ジルコン酸化合物としては、例えば $BaZrO_3$ 、 $ZrSiO_4$ 、 $PbZrO_3$ 、 $MgZrO_3$ 、 $K_2ZrO_3$ が挙げられる。

【0106】C. PZT、PLZT、PLLZT、PBZT等のセラミックスあるいは誘電体(強誘電体)

D. 窒化珪素、窒化アルミ、窒化チタン等の窒化物セラミックス

30 E. 有機高分子材料

有機高分子材料としては、 $-CH-$ 、 $-CO-$ (ケトン)、 $-CONH-$ (アミド)、 $-NH-$ (イミド)、 $-COO-$ (エステル)、 $-N=N-$ (アゾ)、 $-CH=N-$ (シフ)等の結合(光の照射によりこれらの結合が切断される)を有するもの、特に、これらの結合を多く有するものであればいかなるものでもよい。また、有機高分子材料は、構成式中に芳香族炭化水素(1または2以上のベンゼン環またはその縮合環)を有するものであってもよい。

40 【0107】このような有機高分子材料の具体例としては、ポリエチレン、ポリプロピレンのようなポリオレフィン、ポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエーテルスルホン(PES)、エポキシ樹脂等があげられる。

#### 【0108】F. 金属

金属としては、例えば、Al、Li、Ti、Mn、In、Sn、Y、La、Ce、Nd、Pr、Gd、Smまたはこれらのうちの少なくとも1種を含む合金が挙げられる。

【0109】また、分離層120の厚さは、剥離目的や分離層120の組成、層構成、形成方法等の諸条件により異なるが、通常は、1nm～20μm程度であるのが好ましく、10nm～2μm程度であるのがより好ましく、40nm～1μm程度であるのがさらに好ましい。分離層120の膜厚が小さすぎると、成膜の均一性が損なわれ、剥離にムラが生じることがあり、また、膜厚が厚すぎると、分離層120の良好な剥離性を確保するために、光のパワー（光量）を大きくする必要があるとともに、後に分離層120を除去する際に、その作業に時間がかかる。なお、分離層120の膜厚は、できるだけ均一であるのが好ましい。

【0110】分離層120の形成方法は、特に限定されず、膜組成や膜厚等の諸条件に応じて適宜選択される。たとえば、CVD（MOCVD、低圧CVD、ECRCVDを含む）、蒸着、分子線蒸着（MB）、スパッタリング、イオンプレーティング、PVD等の各種気相成膜法、電気メッキ、浸漬メッキ（ディッピング）、無電解メッキ等の各種メッキ法、ラングミュア・プロジェクト（LB）法、スピコート、スプレーコート、ロールコート等の塗布法、各種印刷法、転写法、インクジェット法、粉末ジェット法等が挙げられ、これらのうちの2以上を組み合わせることで形成することもできる。

【0111】なお、分離層120をゾルゲル法によるセラミックスで構成する場合や、有機高分子材料で構成する場合には、塗布法、特に、スピコートにより成膜するのが好ましい。

【0112】〔工程1でのアモルファスシリコン層の形成〕分離層120の組成がアモルファスシリコン（a-Si）の場合には、気相成長法（CVD）、特に低圧（LP）CVDが、プラズマCVD、大気圧（AP）CVD及びECRよりも優れている。

【0113】例えばプラズマCVDにより形成されたアモルファスシリコン層中には、比較的多く水素が含有される。この水素の存在により、アモルファスシリコン層をアブレーションさせ易くなるが、成膜時の基板温度が例えば350℃を越えると、そのアモルファスシリコン層より水素が放出される。この薄膜デバイスの形成工程中に離脱する水素により、膜剥がれが生ずることがある。

【0114】また、プラズマCVD膜は密着性が比較的弱く、デバイス製造工程の中のウェット洗浄工程にて、基板100と被転写層140とが分離される虞がある。

【0115】この点、LPCVD膜は、水素が放出される虞が無く、しかも十分な密着性を確保できる点で優れている。

【0116】次に、分離層としてのアモルファスシリコン層120の膜厚について、図31を参照して説明する。

【0117】図31は、横軸にアモルファスシリコン層

の膜厚を示し、縦軸に該層にて吸収される光エネルギーを示している。上述したように、アモルファスシリコン層に光照射すると、アブレーションを生ずる。

【0118】ここで、アブレーションとは、照射光を吸収した固定材料（分離層120の構成材料）が光化学的または熱的に励起され、その表面や内部の原子または分子の結合が切断されて放出することをいい、主に、分離層120の構成材料の全部または一部が溶融、蒸散（気化）等の相変化を生じる現象として現れる。また、前記相変化によって微小な発砲状態となり、結合力が低下することもある。

【0119】そして、このアブレーションに到達するのに必要な吸収エネルギーが、膜厚が薄い程低くて済むことが、図31から分かる。

【0120】以上のことから、本実施の形態では、分離層としてのアモルファスシリコン層120の膜厚を薄くしている。これにより、アモルファスシリコン層120に照射される光のエネルギーを小さくでき、省エネルギー化と共に、光源装置の小型化が図れる。

【0121】次に、分離層としてのアモルファスシリコン層120の膜厚の数値について考察する。図31の通り、アブレーションに到達するのに必要な吸収エネルギーが、アモルファスシリコンの膜厚が薄い程低くて済むことが分かり、本発明者の考察によると25nm以下が好ましく、一般の光源装置のパワーにより十分にアブレーションを生じさせることができた。膜厚の下限については特に制限はないが、その下限を好ましくは5nmとすると、アモルファスシリコン層の形成を確実に、かつ、所定の密着力を確保できる観点から定められる。従って、分離層としてのアモルファスシリコン層120の膜厚の好適な範囲は、5～25nmとなる。さらに好ましい膜厚は、15nm以下であり、さらなる省エネルギー化と密着力の確保が得られる。最も好適な膜厚範囲は、11nm以下であり、この付近であり、アブレーションに必要な吸収エネルギーを格段に低くできる。

【0122】〔工程2〕次に、図2に示すように、分離層120上に、被転写層（薄膜デバイス層）140を形成する。

【0123】この薄膜デバイス層140のK部分（図2において1点鎖鎖線で囲んで示される部分）の拡大断面図を、図2の右側に示す。図示されるように、薄膜デバイス層140は、例えば、SiO<sub>2</sub>膜（中間層）142上に形成されたTFT（薄膜トランジスタ）を含んで構成され、このTFTは、ポリシリコン層にn型不純物を導入して形成されたソース、ドレイン層146と、チャネル層144と、ゲート絶縁膜148と、ゲート電極150と、層間絶縁膜154と、例えばアルミニウムからなる電極152とを具備する。

【0124】本実施の形態では、分離層120に接して設けられる中間層としてSiO<sub>2</sub>膜を使用しているが、

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>などのその他の絶縁膜を使用することもできる。SiO<sub>2</sub>膜（中間層）の厚みは、その形成目的や発揮し得る機能の程度に応じて適宜決定されるが、通常は、10nm～5μm程度であるのが好ましく、40nm～1μm程度であるのがより好ましい。中間層は、種々の目的で形成され、例えば、被転写層140を物理的または化学的に保護する保護層、絶縁層、導電層、レーザー光の遮光層、マイグレーション防止用のバリア層、反射層としての機能の内の少なくとも1つを発揮するものが挙げられる。

【0125】なお、場合によっては、SiO<sub>2</sub>膜等の中間層を形成せず、分離層120上に直接被転写層（薄膜デバイス層）140を形成してもよい。

【0126】被転写層140（薄膜デバイス層）は、図2の右側に示されるようなTFE等の薄膜デバイスを含む層である。

【0127】薄膜デバイスとしては、TFEの他に、例えば、薄膜ダイオードや、シリコンのPIN接合からなる光電変換素子（光センサ、太陽電池）やシリコン抵抗素子、その他の薄膜半導体デバイス、電極（例：ITO、メサ膜のような透明電極）、スイッチング素子、メモリー、圧電素子等のアクチュエータ、マイクロミラー（ピエゾ薄膜セラミックス）、磁気記録薄膜ヘッド、コイル、インダクター、薄膜高透磁材料およびそれらを組み合わせたマイクロ磁気デバイス、フィルター、反射膜、ダイクロイックミラー等がある。

【0128】このような薄膜デバイスは、その形成方法との関係で、通常、比較的高いプロセス温度を経て形成される。したがって、この場合、前述したように、基板100としては、そのプロセス温度に耐え得る信頼性の高いものが必要となる。

【0129】[工程3]次に、図3に示すように、薄膜デバイス層140を、接着層160を介して転写体180に接合（接着）する。

【0130】接着層160を構成する接着剤の好適な例としては、反応硬化型接着剤、熱硬化型接着剤、紫外線硬化型接着剤等の光硬化型接着剤、嫌気硬化型接着剤等の各種硬化型接着剤が挙げられる。接着剤の組成としては、例えば、エポキシ系、アクリレート系、シリコン系等、いかなるものでもよい。このような接着層160の形成は、例えば、塗布法によりなされる。

【0131】前記硬化型接着剤を用いる場合、例えば被転写層（薄膜デバイス層）140上に硬化型接着剤を塗布し、その上に転写体180を接合した後、硬化型接着剤の特性に応じた硬化方法により前記硬化型接着剤を硬化させて、被転写層（薄膜デバイス層）140と転写体180とを接着し、固定する。

【0132】接着剤が光硬化型の場合、光透過性の基板100または光透過性の転写体180の一方の外側から（あるいは光透過性の基板及び転写体の両外側から）光

を照射する。接着剤としては、薄膜デバイス層に影響を与えにくい紫外線硬化型などの光硬化型接着剤が好ましい。

【0133】なお、図示と異なり、転写体180側に接着層160を形成し、その上に被転写層（薄膜デバイス層）140を接着してもよい。なお、例えば転写体180自体が接着機能を有する場合等には、接着層160の形成を省略してもよい。

【0134】転写体180としては、特に限定されないが、基板（板材）、特に透明基板が挙げられる。なお、このような基板は平板であっても、湾曲板であってもよい。また、転写体180は、前記基板100に比べ、耐熱性、耐食性等の特性が劣るものであってもよい。その理由は、本発明では、基板100側に被転写層（薄膜デバイス層）140を形成し、その後、被転写層（薄膜デバイス層）140を転写体180に転写するため、転写体180に要求される特性、特に耐熱性は、被転写層（薄膜デバイス層）140の形成の際の温度条件等に依存しないからである。

【0135】したがって、被転写層140の形成の際の最高温度をT<sub>max</sub>としたとき、転写体0の構成材料として、ガラス転移点（T<sub>g</sub>）または軟化点がT<sub>max</sub>以下のものを用いることができる。例えば、転写体180は、ガラス転移点（T<sub>g</sub>）または軟化点が好ましくは800℃以下、より好ましくは500℃以下、さらに好ましくは320℃以下の材料で構成することができる。

【0136】また、転写体180の機械的特性としては、ある程度の剛性（強度）を有するものが好ましいが、可撓性、弾性を有するものであってもよい。転写体180の機械的特性は、特に下記の点を考慮するとよい。

【0137】この分離層120に光照射すると、分離層120を構成する物質が光化学的または熱的に励起され、その表面や内部の分子または原子の結合が切断されて、該分子または原子が外部に放出される。この分子または原子の放出に伴い分離層120の上層に作用する応力を、転写体180にて受けとめられるように、転写体180の機械的強度によりその耐力を確保することが好ましい。それにより、分離層120の上層の変形または破壊が防止されるからである。

【0138】このような耐力を、転写体180の機械的強度だけで確保するものに限らず、分離層120よりも上層に位置する層、すなわち、被転写層140、接着層160及び転写体180のいずれか一つまたは複数の層の機械的強度により確保すればよい。このような耐力を確保するために、被転写層140、接着層160及び転写体180の材質及び厚さを適宜選択できる。

【0139】被転写層140、接着層160及び転写体180のみでは上記の耐力を確保できない場合には、図35（A）～（E）に示すように、分離層120よりも



上層となるいずれかの位置に、補強層 132 を形成することもできる。

【0140】図 35 (A) に示す補強層 132 は、分離層 120 と被転写層 140 との間に設けられている。こうすると、分離層 120 にて剥離を生じさせ、その後基板 100 を離脱させた後に、残存する分離層 120 と共に補強層 132 を、被転写層 140 から除去することもできる。図 35 (B) のように、転写体 180 の上層に設けられた補強層 132 も、少なくとも分離層 120 にて剥離を生じさせた後は、転写体 180 より除去することができる。

【0141】図 35 (C) に示す補強層 132 は、被転写層 140 を構成する複数層の中に、例えば絶縁層として介在されている。図 35 (D) (E) の各補強層 132 は、接着層 140 の下層または上層に配置されている。これらの場合には、後に除去することは不能となる。

【0142】転写体 180 の構成材料としては、各種合成樹脂または各種ガラス材が挙げられ、特に、各種合成樹脂や通常の（低融点の）安価なガラス材が好ましく、上記の耐力を考慮して厚さを決定することもできる。

【0143】合成樹脂としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂のいずれでもよく、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-ブレンデン共重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体 (EVA) 等のポリオレフィン、環状ポリオレフィン、変性ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリカーボネート、ポリ- (4-メチルペンテン-1)、アイオノマー、アクリル系樹脂、ポリメチルメタクリレート、アクリル-スチレン共重合体 (AS 樹脂)、ブタジエン-スチレン共重合体、ポリオ共重合体 (EVOH)、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリブチレンテレフタレート (PBT)、ポリシクロヘキサントレフタレート (PCT) 等のポリエステル、ポリエーテル、ポリエーテルケトン (PEK)、ポリエーテルイミド、ポリアセタール (POM)、ポリフェニレンオキシド、変性ポリフェニレンオキシド、ポリアリレート、芳香族ポリエステル (液晶ポリマー)、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、その他フッ素系樹脂、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可塑性エラストマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル、シリコーン樹脂、ポリウレタン等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらのうちの 1 種または 2 種以上を組み合わせる（例えば 2 層以上の積層体として）用いることができる。

【0144】ガラス材としては、例えば、ケイ酸ガラス

(石英ガラス)、ケイ酸アルカリガラス、ソーダ石灰ガラス、カリ石灰ガラス、鉛 (アルカリ) ガラス、バリウムガラス、ホウケイ酸ガラス等が挙げられる。このうち、ケイ酸ガラス以外のものは、ケイ酸ガラスに比べて融点が低く、また、成形、加工も比較的容易であり、しかも安価であり、好ましい。

【0145】転写体 180 として合成樹脂で構成されたものを用いる場合には、大型の転写体 180 を一体的に成形することができるとともに、湾曲面や凹凸を有するもの等の複雑な形状であっても容易に製造することができ、また、材料コスト、製造コストも安価であるという種々の利点が享受できる。したがって、合成樹脂の使用は、大型で安価なデバイス (例えば、液晶ディスプレイ) を製造する上で有利である。

【0146】なお、転写体 180 は、例えば、液晶セルのように、それ自体独立したデバイスを構成するものや、例えばカラーフィルター、電極層、誘電体層、絶縁層、半導体素子のように、デバイスの一部を構成するものであってもよい。

【0147】さらに、転写体 180 は、金属、セラミックス、石材、木材紙等の物質であってもよいし、ある品物を構成する任意の面上 (時計の面上、エアコンの表面上、プリント基板の上等)、さらには壁、柱、天井、窓ガラス等の構造物の表面上であってもよい。

【0148】[工程 4] 次に、図 4 に示すように、基板 100 の裏面側から光を照射する。

【0149】この光は、基板 100 を透過した後に分離層 120 に照射される。これにより、分離層 120 に層内剥離および/または界面剥離が生じ、結合力が減少または消滅する。

【0150】分離層 120 の層内剥離および/または界面剥離が生じる原理は、分離層 120 の構成材料にアブレーションが生じること、また、分離層 120 に含まれているガスの放出、さらには照射直後に生じる熔融、蒸散等の相変化によるものであることが推定される。

【0151】分離層 120 が層内剥離を生じるか、界面剥離を生じるか、またはその両方であるかは、分離層 120 の組成や、その他種々の要因に左右され、その要因の 1 つとして、照射される光の種類、波長、強度、到達深さ等の条件が挙げられる。

【0152】照射する光としては、分離層 120 に層内剥離および/または界面剥離を起こさせるものであればいかなるものでもよく、例えば、X 線、紫外線、可視光、赤外線 (熱線)、レーザ光、ミリ波、マイクロ波、電子線、放射線 ( $\alpha$  線、 $\beta$  線、 $\gamma$  線) 等が挙げられる。そのなかでも、分離層 120 の剥離 (アブレーション) を生じさせ易いという点で、レーザ光が好ましい。

【0153】このレーザ光を発生させるレーザ装置としては、各種気体レーザ、固体レーザ (半導体レーザ) 等が挙げられるが、エキシマレーザ、Nd-YAG レー

ザ、Ar レーザ、CO<sub>2</sub> レーザ、CO レーザ、He-Ne レーザ等が好適に用いられ、その中でもエキシマレーザが特に好ましい。

【0154】エキシマレーザは、短波長域で高エネルギーを出力するため、極めて短時間で分離層2にアブレーションを生じさせることができ、よって隣接する転写体180や基板100等に温度上昇をほとんど生じさせることなく、すなわち劣化、損傷を生じさせることなく、分離層120を剥離することができる。

【0155】また、分離層120にアブレーションを生じさせるに際して、光の波長依存性がある場合、照射されるレーザ光の波長は、100nm～350nm程度であるのが好ましい。

【0156】図7に、基板100の、光の波長に対する透過率の一例を示す。図示されるように、300nmの波長に対して透過率が急峻に増大する特性をもつ。このような場合には、300nm以上の波長の光（例えば、波長308nmのXe-CIエキシマレーザ光）を照射する。

【0157】また、分離層120に、例えばガス放出、気化、昇華等の相変化を起こさせて分離特性を与える場合、照射されるレーザ光の波長は、350から1200nm程度であるのが好ましい。

【0158】また、照射されるレーザ光のエネルギー密度、特に、エキシマレーザの場合のエネルギー密度は、10～5000mJ/cm<sup>2</sup>程度とするのが好ましく、100～1000mJ/cm<sup>2</sup>程度とするのがより好ましい。また、照射時間は、1～1000nsec程度とするのが好ましく、10～100nsec程度とするのがより好ましい。エネルギー密度が低いかまたは照射時間が短いと、十分なアブレーション等が生じず、また、エネルギー密度が高いかまたは照射時間が長いと、分離層120を透過した照射光により被転写層140に悪影響を及ぼすおそれがある。

【0159】ここで、本実施の形態では、分離層120を例えば10nmの膜厚のアモルファスシリコン層にて形成しているので、比較的小さな光エネルギーの吸収により、アモルファスシリコン層120にアブレーションを起こすことができる。このように比較的小さな光エネルギーをアモルファスシリコン層120に吸収させる好適な方法を、図32を用いて説明する。

【0160】図32は、ラインビームを間欠的に走査させて、基板100を介して分離層120のほぼ全面に光照射する方法を示している。各図において、ラインビームをビームスキャンした回数をNで表した時、N回目のラインビームの照射領域20(N)と、N+1回目のラインビームの照射領域20(N+1)とは重ならないようにして、各回のビームスキャンが実施されている。このため、隣り合う照射領域20(N)と20(N+1)との間には、各回の照射領域よりも十分に狭い低照射領

域あるいは非照射領域30が形成される。

【0161】ここで、ラインビーム10を基板100に対して相対的に移動させる時に、その移動時にもビームを射出し続けると、符号30の領域は低照射領域となる。一方、移動時にはラインビーム10を射出しないようにすると、符号30の領域は非照射領域となる。

【0162】図32の方式とは異なり、もし各回のビーム照射領域同士を重ねさせると、分離層120の層内および／または界面において剥離を生じさせるに足る光以上の過度の光が照射されることになる。この過度の光の一部が漏れて分離層120を介して薄膜デバイスを含む被転写層140に入射すると、その薄膜デバイスの特性例えば電気的特性を劣化する原因となる。

【0163】図32の方式では、そのような過度の光が分離層120に照射されないため、薄膜デバイスが転写体に転写された後も、その薄膜デバイスの本来の特性を維持することができる。なお、低照射領域あるいは非照射領域30に対応する分離層120では剥離が生じないが、その両側のビーム照射領域での剥離により、分離層120と基板100との密着性を十分に低減させることができる。

【0164】なお、分離層120を透過した照射光が被転写層140にまで達して悪影響を及ぼす場合の対策としては、例えば、図30に示すように、分離層（レーザ吸収層）120上にタンタル（Ta）等の金属膜124を形成する方法がある。これにより、分離層120を透過したレーザ光は、金属膜124の界面で完全に反射され、それより上の薄膜デバイスに悪影響を与えない。

【0165】ただし、図30のように、金属膜124を形成すると、その上に薄膜デバイスを形成する必要があり、金属膜124と薄膜デバイスとの間にシリコン系の絶縁層を介在させたとしても、薄膜デバイスが金属汚染される虞がある。

【0166】そこで、図30に代わる方法として、図33、図34に示すよう方法を採用することが好ましい。

【0167】図33は、分離層としてのアモルファスシリコン層120を用いた例であり、被転写層140の下層に、シリコン系光吸収層として用いられるアモルファスシリコン層126をさらに設けている。この2つのアモルファスシリコン層120、126を分離するために、シリコン系介在層として例えばシリコン酸化膜（SiO<sub>2</sub>）が介在されている。

【0168】こうすると、万一照射光が分離層であるアモルファスシリコン層120を透過しても、その透過光はシリコン系光吸収層としてのアモルファスシリコン層126に吸収される。この結果、それより上の薄膜デバイスに悪影響を与えない。

【0169】しかも、追加された2つの層126、128は共にシリコン系の層であるので、従来の薄膜形成技



術にて確立されているように、金属汚染などを引き起こすことがない。

【0170】なお、分離層としてのアモルファスシリコン層120の膜厚よりも、光吸収層としてのアモルファスシリコン層126の膜厚を厚くしておけば、アモルファスシリコン層126にてアブレーションが生ずる虞を確実に防止できる。しかし、上記の膜厚の關係に限らず、アモルファスシリコン層126に入射する光エネルギーは、分離層としてのアモルファスシリコン層120に直接入射する光エネルギーよりも十分に少ないため、アモルファスシリコン層126にてアブレーションが生ずることを防止できる。

【0171】なお、図34に示すように、分離層120と異なる材質のシリコン系光吸収層130を設けた例を示し、この場合にはシリコン系介在層128は必ずしも設ける必要はない。

【0172】図33、図34の通り構成して分離層120での光漏れ対策を行った場合には、分離層120にて剥離が生ずるための光吸収エネルギーが大きい場合であっても、薄膜デバイスへの悪影響を確実に防止できる利点がある。

【0173】レーザ光に代表される照射光は、その強度が均一となるように照射されるのが好ましい。照射光の照射方向は、分離層120に対し垂直な方向に限らず、分離層120に対し所定角度傾斜した方向であってもよい。

【0174】次に、図5に示すように、基板100に力を加えて、この基板100を分離層120から離脱させる。図5では図示されないが、この離脱後、基板100上に分離層が付着することもある。

【0175】次に、図6に示すように、残存している分離層120を、例えば洗浄、エッチング、アッシング、研磨等の方法またはこれらを組み合わせた方法により除去する。これにより、被転写層（薄膜デバイス層）140が、転写体180に転写されたことになる。

【0176】なお、離脱した基板100にも分離層の一部が付着している場合には同様に除去する。なお、基板100が石英ガラスのような高価な材料、希少な材料で構成されている場合等には、基板100は、好ましくは再利用（リサイクル）に供される。すなわち、再利用したい基板100に対し、本発明を適用することができ、有用性が高い。

【0177】以上のような各工程を経て、被転写層（薄膜デバイス層）140の転写体180への転写が完了する。その後、被転写層（薄膜デバイス層）140に隣接するSiO<sub>2</sub>膜の除去や、被転写層140上への配線等の導電層や所望の保護膜の形成等を行うこともできる。

【0178】本発明では、被剥離物である被転写層（薄膜デバイス層）140自体を直接に剥離するのではなく、被転写層（薄膜デバイス層）140に接合された分

離層において剥離するため、被剥離物（被転写層140）の特性、条件等にかかわらず、容易かつ確実に、しかも均一に剥離（転写）することができ、剥離操作に伴う被剥離物（被転写層140）へのダメージもなく、被転写層140の高い信頼性を維持することができる。

【0179】（第2の実施の形態）基板上にCMOS構造のTFTを形成し、これを転写体に転写する場合の具体的な製造プロセスの例を図8～図18を用いて説明する。

【0180】（工程1）図8に示すように、基板（例えば石英基板）100上に、分離層としてLPCVD法により形成されたアモルファスシリコン層120を形成する。このアモルファスシリコン層120の膜厚は、例えば10nmである。その上に、中間層（例えば、SiO<sub>2</sub>膜）142と、アモルファスシリコン層（例えばLPCVD法により形成される）143とを順次に積層形成し、続いて、アモルファスシリコン層143の全面に上方からレーザー光を照射し、アニールを施す。これにより、アモルファスシリコン層143は再結晶化してポリシリコン層となる。ここで、図33に示したように、分離層となるアモルファスシリコン層120と中間層142との間に、シリコン系介在層例えばシリコン酸化膜128と、光吸収用の別のアモルファスシリコン層126を形成することもできる。

【0181】（工程2）続いて、図9に示すように、レーザーアニールにより得られたポリシリコン層をパターニングして、アイランド144a、144bを形成する。

【0182】（工程3）図10に示されるように、アイランド144a、144bを覆うゲート絶縁膜148a、148bを、例えば、CVD法により形成する。

【0183】（工程4）図11に示されるように、ポリシリコンあるいはメタル等からなるゲート電極150a、150bを形成する。

【0184】（工程5）図12に示すように、ポリイミド等からなるマスク層170を形成し、ゲート電極150bおよびマスク層170をマスクとして用い、セルフアラインで、例えばボロン（B）のイオン注入を行う。これによって、p<sup>+</sup>層172a、172bが形成される。

【0185】（工程6）図13に示すように、ポリイミド等からなるマスク層174を形成し、ゲート電極150aおよびマスク層174をマスクとして用い、セルフアラインで、例えばリン（P）のイオン注入を行う。これによって、n<sup>+</sup>層146a、146bが形成される。

【0186】（工程7）図14に示すように、層間絶縁膜154を形成し、選択的にコンタクトホール形成後、電極152a～152dを形成する。

【0187】このようにして形成されたCMOS構造の

TFTが、図2～図6における被転写層（薄膜デバイス層）140に該当する。なお、層間絶縁膜154上に保護膜を形成してもよい。

【0188】（工程8）図15に示すように、CMOS構成のTFT上に接着層としてのエポキシ樹脂層160を形成し、次に、そのエポキシ樹脂層160を介して、TFTを転写体（例えば、ソーダガラス基板）180に貼り付ける。続いて、熱を加えてエポキシ樹脂を硬化させ、転写体180とTFTとを接着（接合）する。

【0189】なお、接着層160は紫外線硬化型接着剤であるフォトリソマー樹脂でもよい。この場合は、熱ではなく転写体180側から紫外線を照射してポリマーを硬化させる。

【0190】（工程9）図16に示すように、基板100の裏面から、例えば、Xe-C1エキシマレーザ光を、例えば図32のビームスキャンにより照射する。これにより、分離層120の層内および／または界面において剥離を生じせしめる。このとき、分離層であるアモルファスシリコン層120の膜厚が10nmであるため、剥離を生じさせるための光エネルギーを十分低減できた。また、アモルファスシリコン層120の剥離の際に、そのアモルファスシリコン層120よりも上層の各層142、154、160、180に応力が作用するが、この応力はその上層に142、154、160、180によって受けとめられ、薄膜デバイスの変形及び破壊が防止される。

【0191】（工程10）図17に示すように、基板100を引き剥がす。

【0192】（工程11）最後に、分離層120をエッチングにより除去する。これにより、図18に示すように、CMOS構成のTFTが、転写体180に転写されたことになる。なお、図33に示したように、シリコン系介在層例えばシリコン酸化膜128と、光吸収用の別のアモルファスシリコン層126とが分離層120上に形成されている場合には、分離層120のエッチング除去工程の前に、次の2工程を追加することもできる。その一つは、例えばドライエッチングにて光吸収層であるアモルファスシリコン層126を除去する工程であり、他の一つは、例えばフッ酸などでシリコン酸化物128を除去する工程である。

【0193】（第3の実施の形態）上述の第1の実施の形態および第2の実施の形態で説明した技術を用いると、例えば、図19（a）に示すような、薄膜デバイスを用いて構成されたマイクロコンピュータを所望の基板上に形成できるようになる。

【0194】図19（a）では、プラスチック等からなるフレキシブル基板182上に、薄膜デバイスを用いて回路が構成されたCPU300、RAM320、入出力回路360ならびに、これらの回路の電源電圧を供給するための、アモルファスシリコンのPIN接合を具備す

る太陽電池340が搭載されている。

【0195】図19（a）のマイクロコンピュータはフレキシブル基板上に形成されているため、図19（b）に示すように曲げに強く、また、軽量であるために落下にも強いという特徴がある。

【0196】（第4の実施の形態）本実施の形態では、上述の薄膜デバイスの転写技術を用いて、図20、図21に示されるような、アクティブマトリクス基板を用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置を作成する場合の製造プロセスの例について説明する。

【0197】（液晶表示装置の構成）図20に示すように、アクティブマトリクス型の液晶表示装置は、バックライト等の照明光源400、偏光板420、アクティブマトリクス基板440、液晶460、対向基板480、偏光板500を具備する。

【0198】なお、本発明のアクティブマトリクス基板440と対向基板480にプラスチックフィルムのようなフレキシブル基板を用いる場合は、照明光源400に代えて反射板を採用した反射型液晶パネルとして構成すると、可撓性があって衝撃に強くかつ軽量のアクティブマトリクス型液晶パネルを実現できる。なお、画素電極を金属で形成した場合、反射板および偏光板420は不要となる。

【0199】本実施の形態で使用するアクティブマトリクス基板440は、画素部442にTFTを配置し、さらに、ドライバ回路（走査線ドライバおよびデータ線ドライバ）444を搭載したドライバ内蔵型のアクティブマトリクス基板である。

【0200】このアクティブマトリクス型液晶表示装置の要部の断面図が図21に示され、また、液晶表示装置の要部の回路構成が図22に示される。

【0201】図22に示されるように、画素部442は、ゲートがゲート線G1に接続され、ソース・ドレインの一方がデータ線D1に接続され、ソース・ドレインの他方が液晶460に接続されたTFT（M1）と、液晶460とを含む。

【0202】また、ドライバー部444は、画素部のTFT（M1）と同じプロセスにより形成されるTFT（M2）を含んで構成される。

【0203】図21の左側に示されるように、画素部442におけるTFT（M1）は、ソース・ドレイン層1100a、1100bと、チャンネル1100eと、ゲート絶縁膜1200aと、ゲート電極1300aと、絶縁膜1500と、ソース・ドレイン電極1400a、1400bとを含んで構成される。

【0204】なお、参照番号1700は画素電極であり、参照番号1702は画素電極1700が液晶460に電圧を印加する領域（液晶への電圧印加領域）を示す。図中、配向膜は省略してある。画素電極1700はITO（光透過型の液晶パネルの場合）あるいはアルミ

ニウム等の金属（反射型の液晶パネルの場合）により構成される。また、図21では、液晶への電圧印加領域1702において、画素電極1700の下の下地絶縁膜（中間層）1000は完全に除去されているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、下地絶縁膜（中間層）1000が薄いために液晶への電圧印加の妨げにならない場合には残しておいてもよい。

【0205】また、図21の右側に示されるように、ドライバ部444を構成するTF T（M2）は、ソース、ドレイン層1100c、1100dと、チャンネル1100fと、ゲート絶縁膜1200bと、ゲート電極1300bと、絶縁膜1500と、ソース・ドレイン電極1400c、1400dとを含んで構成される。

【0206】なお、図21において、参照番号480は、例えば、対向基板（例えば、ソーダガラス基板）であり、参照番号482は共通電極である。また、参照番号1000はSiO<sub>2</sub>膜であり、参照番号1600は層間絶縁膜（例えば、SiO<sub>2</sub>膜）であり、参照番号1800は接着層である。また、参照番号1900は、例えばソーダガラス基板からなる基板（転写体）である。

【0207】（液晶表示装置の製造プロセス）以下、図21の液晶表示装置の製造プロセスについて、図23～図27を参照して説明する。

【0208】まず、図8～図18と同様の製造プロセスを経て、図23のようなTF T（M1、M2）を、信頼性が高くかつレーザー光を透過する基板（例えば、石英基板）3000上に形成し、保護膜1600を構成する。なお、図23において、参照番号3100は分離層（レーザー吸収層）である。また、図23では、TF T（M1、M2）は共にn型のMOSFETとしている。但し、これに限定されるものではなく、p型のMOSFETや、CMOS構造としてもよい。

【0209】次に、図24に示すように、保護膜1600および下地絶縁膜1000を選択的にエッチングし、選択的に開口部4000、4200を形成する。これらの2つの開口部は共通のエッチング工程を用いて同時に形成する。なお、図24では開口部4200において、下地絶縁膜（中間層）1000を完全に除去しているが、必ずしもこれに限定されるものではなく、下地絶縁膜（中間層）1000が薄いために液晶への電圧印加の妨げにならない場合には残しておいてもよい。

【0210】次に、図25に示すように、ITO膜あるいはアルミニウム等の金属からなる画素電極1700を形成する。ITO膜を用いる場合には透過型の液晶パネルとなり、アルミニウム等の金属を用いる場合には反射型の液晶パネルとなる。次に、図26に示すように、接着層1800を介して基板1900を接合（接着）する。

【0211】次に、図26に示すように、基板3000の裏面からエキシマレーザー光を照射し、この後、基板

3000を引き剥がす。

【0212】次に、分離層（レーザー吸収層）3100を除去する。これにより、図27に示すようなアクティブマトリクス基板440が完成する。画素電極1700の底面（参照番号1702の領域）は露出しており、液晶との電気的な接続が可能となっている。この後、アクティブマトリクス基板440の絶縁膜（SiO<sub>2</sub>などの中間層）1000の表面および画素電極1702表面に配向膜を形成して配向処理が施される。図27では、配向膜は省略してある。

【0213】そして、さらにその表面に画素電極1709と対向する共通電極が形成され、その表面が配向処理された対向基板480と図21のアクティブマトリクス基板440とを封止材（シール材）で封止し、両基板の間に液晶を封入して、図21に示すような液晶表示装置が完成する。

【0214】（第5の実施の形態）図28に本発明の第5の実施の形態を示す。

【0215】本実施の形態では、上述の薄膜デバイスの転写方法を複数回実行して、転写元の基板よりも大きい基板（転写体）上に薄膜デバイスを含む複数のパターンを転写し、最終的に大規模なアクティブマトリクス基板を形成する。

【0216】つまり、大きな基板7000上に、複数回の転写を実行し、画素部7100a～7100pを形成する。図28の上側に一点鎖線で囲んで示されるように、画素部には、TF Tや配線が形成されている。図28において、参照番号7210は走査線であり、参照番号7200は信号線であり、参照番号7230はゲート電極であり、参照番号7230は画素電極である。

【0217】信頼性の高い基板を繰り返し使用し、あるいは複数の第1の基板を使用して薄膜パターンの転写を複数回実行することにより、信頼性の高い薄膜デバイスを搭載した大規模なアクティブマトリクス基板を作成できる。

【0218】（第6の実施の形態）本発明の第6の実施の形態を図29に示す。

【0219】本実施の形態の特徴は、上述の薄膜デバイスの転写方法を複数回実行して、転写元の基板上よりも大きな基板上に、設計ルール（つまりパターン設計する上でのデザインルール）が異なる薄膜デバイス（つまり、最小線幅が異なる薄膜デバイス）を含む複数のパターンを転写することである。

【0220】図29では、ドライバ搭載のアクティブマトリクス基板において、画素部（7100a～7100p）よりも、より微細な製造プロセスで作成されたドライバ回路（8000～8032）を、複数回の転写によって基板6000の周囲に作成してある。

【0221】ドライバ回路を構成するシフトレジスタは、低電圧下においてロジックレベルの動作をするので

10

20

30

40

50

画素TFTよりも耐圧が低くてよく、よって、画素TFTより微細なTFTとなるようにして高集積化を図ることができる。

【0222】本実施の形態によれば、設計ルールレベルの異なる（つまり製造プロセスが異なる）複数の回路を、一つの基板上に実現できる。なお、シフトレジスタの制御によりデータ信号をサンプリングするサンプリング手段（図22の薄膜トランジスタM2）は、画素TFT同様に高耐圧が必要なので、画素TFTと同一プロセス／同一設計ルールで形成するとよい。

【0223】

【実施例】次に、本発明の具体的実施例について説明する。

【0224】（実施例1）縦50mm×横50mm×厚さ1.1mmの石英基板（軟化点：1630℃、歪点：1070℃、エキシマレーザの透過率：ほぼ100%）を用意し、この石英基板の片面に、分離層（レーザ光吸収層）として非晶質シリコン（a-Si）膜を低圧CVD法（Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub>ガス、425℃）により形成した。分離層の膜厚としては、10nmと100nmの2種類のものを形成した。

【0225】次に、分離層上に、中間層としてSiO<sub>2</sub>膜をECR-CVD法（SiH<sub>4</sub>+O<sub>2</sub>ガス、100℃）により形成した。中間層の膜厚は、200nmであった。

【0226】次に、中間層上に、被転写層として膜厚50nmの非晶質シリコン膜を低圧CVD法（Si<sub>2</sub>H<sub>6</sub>ガス、425℃）により形成し、この非晶質シリコン膜にレーザ光（波長308nm）を照射して、結晶化させ、ポリシリコン膜とした。その後、このポリシリコン膜に対し、所定のパターンニングを施し、薄膜トランジスタのソース・ドレイン・チャネルとなる領域を形成した。この後、1000℃以上の高温によりポリシリコン膜表面を熱酸化してゲート絶縁膜SiO<sub>2</sub>を形成した後、ゲート絶縁膜上にゲート電極（ポリシリコンにMo等の高融点金属が積層形成された構造）を形成し、ゲート電極をマスクとしてイオン注入することによって、自己整合的（セルフアライン）にソース・ドレイン領域を形成し、薄膜トランジスタを形成した。この後、必要に応じて、ソース・ドレイン領域に接続される電極及び配線、ゲート電極につながる配線が形成される。これらの電極や配線にはAlが使用されるが、これに限定されるものではない。また、後工程のレーザ照射によりAlの溶解が心配される場合は、Alよりも高融点の金属（後工程のレーザ照射により溶解しないもの）を使用してもよい。

【0227】次に、前記薄膜トランジスタの上に、紫外線硬化型接着剤を塗布し（膜厚：100μm）、さらにその塗膜に、転写体として縦200mm×横300mm×厚さ1.1mmの大型の透明なガラス基板（ソーダガラス、

軟化点：740℃、歪点：511℃）を接合した後、ガラス基板側から紫外線を照射して接着剤を硬化させ、これらを接着固定した。

【0228】次に、Xe-C1エキシマレーザ（波長：308nm）を石英基板側から照射し、分離層に剥離（層内剥離および界面剥離）を生じさせた。照射したXe-C1エキシマレーザのエネルギー密度は、300mJ/cm<sup>2</sup>、照射時間は、20nsecであった。なお、エキシマレーザの照射は、スポットビーム照射とラインビーム照射とがあり、スポットビーム照射の場合は、所定の単位領域（例えば8mm×8mm）にスポット照射し、このスポット照射を単位領域の1/10程度ずつずらしながら照射していく。また、ラインビーム照射の場合は、所定の単位領域（例えば378mm×0.1mmや378mm×0.3mm（これらはエネルギーの90%以上が得られる領域））を同じく1/10程度ずつずらしながら照射していく。これにより、分離層の各点は少なくとも10回の照射を受ける。このレーザ照射は、石英基板全面に対して、照射領域をずらしながら実施される。以上の方法は、分離層の膜厚を100nmとし、アブレーションのために光エネルギー吸収を多くする場合に有効である。分離層の膜厚を10nmとした場合には、図32のように、ビームスキャンにより隣り合う2つのビーム照射領域（例えば図32の20（N）と20（N+1）の2つのビーム照射領域）を互いに重ね合わせないようにしても、アブレーションを生じさせることができ、しかも薄膜デバイスへの悪影響を低減できる。なお、このとき、分離層の上層の各層のトータルの耐力により、薄膜デバイスが変形することも破壊されることもなかった。

【0229】この後、石英基板とガラス基板（転写体）とを分離層において引き剥がし、石英基板上に形成された薄膜トランジスタおよび中間層を、ガラス基板側に転写した。

【0230】その後、ガラス基板側の中間層の表面に付着した分離層を、エッチングや洗浄またはそれらの組み合わせにより除去した。また、石英基板についても同様の処理を行い、再使用に供した。

【0231】なお、転写体となるガラス基板が石英基板より大きな基板であれば、本実施例のような石英基板からガラス基板への転写を、平面的に異なる領域に繰り返して実施し、ガラス基板上に、石英基板に形成可能な薄膜トランジスタの数より多くの薄膜トランジスタを形成することができる。さらに、ガラス基板上に繰り返し積層し、同様により多くの薄膜トランジスタを形成することができる。

【0232】（実施例2）分離層を、H（水素）を20at%含有する非晶質シリコン膜とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0233】なお、非晶質シリコン膜中のH量の調整は、低圧CVD法による成膜時の条件を適宜設定するこ

とにより行った。

【0234】（実施例3）分離層を、スピンコートによりゾルゲル法で形成したセラミックス薄膜（組成： $\text{PbTiO}_3$ 、膜厚：200nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0235】（実施例4）分離層を、スパッタリングにより形成したセラミックス薄膜（組成： $\text{BaTiO}_3$ 、膜厚：400nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0236】（実施例5）分離層を、レーザーアブレーション法により形成したセラミックス薄膜（組成： $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$ （PZT）、膜厚：50nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0237】（実施例6）分離層を、スピンコートにより形成したポリイミド膜（膜厚：200nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0238】（実施例7）分離層を、スピンコートにより形成したポリフェニレンサルファイド膜（膜厚：200nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0239】（実施例8）分離層を、スパッタリングにより形成したAl層（膜厚：300nm）とした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0240】（実施例9）照射光として、Kr-Fエキシマレーザ（波長：248nm）を用いた以外は実施例2と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。なお、照射したレーザのエネルギー密度は、250mJ/cm<sup>2</sup>、照射時間は、20nsecであった。

【0241】（実施例10）照射光として、Nd-YAGレーザ（波長：1068nm）を用いた以外は実施例2と同様にして薄膜トランジスタの転写を行った。なお、照射したレーザのエネルギー密度は、400mJ/cm<sup>2</sup>、照射時間は、20nsecであった。

【0242】（実施例11）被転写層として、高温プロセス1000℃によるポリシリコン膜（膜厚80nm）の薄膜トランジスタとした以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0243】（実施例12）転写体として、ポリカーボネート（ガラス転移点：130℃）製の透明基板を用いた以外は実施例1と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0244】（実施例13）転写体として、AS樹脂（ガラス転移点：70～90℃）製の透明基板を用いた以外は実施例2と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0245】（実施例14）転写体として、ポリメチルメタクリレート（ガラス転移点：70～90℃）製の透

明基板を用いた以外は実施例3と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0246】（実施例15）転写体として、ポリエチレンテレフタレート（ガラス転移点：67℃）製の透明基板を用いた以外は、実施例5と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0247】（実施例16）転写体として、高密度ポリエチレン（ガラス転移点：77～90℃）製の透明基板を用いた以外は実施例6と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。（実施例17）転写体として、ポリアミド（ガラス転移点：145℃）製の透明基板を用いた以外は実施例9と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0248】（実施例18）転写体として、エポキシ樹脂（ガラス転移点：120℃）製の透明基板を用いた以外は実施例10と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0249】（実施例19）転写体として、ポリメチルメタクリレート（ガラス転移点：70～90℃）製の透明基板を用いた以外は実施例11と同様にして、薄膜トランジスタの転写を行った。

【0250】実施例1～19について、それぞれ、転写された薄膜トランジスタの状態を肉眼と顕微鏡とで視観察したところ、いずれも、欠陥やムラがなく、均一に転写がなされていた。

【0251】以上述べたように、本発明の転写技術を用いれば、薄膜デバイス（被転写層）を種々の転写体へ転写することが可能となる。例えば、薄膜を直接形成することができないかまたは形成するのに適さない材料、成形が容易な材料、安価な材料等で構成されたものや、移動しにくい大型の物体等に対しても、転写によりそれを形成することができる。

【0252】特に、転写体は、各種合成樹脂や融点の低いガラス材のような、基板材料に比べ耐熱性、耐食性等の特性が劣るものを用いることができる。そのため、例えば、透明基板上に薄膜トランジスタ（特にポリシリコンTFT）を形成した液晶ディスプレイを製造するに際しては、基板として、耐熱性に優れる石英ガラス基板を用い、転写体として、各種合成樹脂や融点の低いガラス材のような安価でかつ加工のし易い材料の透明基板を用いることにより、大型で安価な液晶ディスプレイを容易に製造することができるようになる。このような利点は、液晶ディスプレイに限らず、他のデバイスの製造についても同様である。

【0253】また、以上のような利点を享受しつつも、信頼性の高い基板、特に石英ガラス基板のような耐熱性の高い基板に対し機能性薄膜のような被転写層を形成し、さらにはパターニングすることができるので、転写体の材料特性にかかわらず、転写体上に信頼性の高い機能性薄膜を形成することができる。

【0254】また、このような信頼性の高い基板は、高価であるが、それを再利用することも可能であり、よって、製造コストも低減される。

【0255】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第1の工程を示す断面図である。

【図2】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第2の工程を示す断面図である。

【図3】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第3の工程を示す断面図である。

【図4】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第4の工程を示す断面図である。

【図5】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第5の工程を示す断面図である。

【図6】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第1の実施の形態における第6の工程を示す断面図である。

【図7】第1の基板（図1の基板100）のレーザー光の波長に対する透過率の変化を示す図である。

【図8】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第1の工程を示す断面図である。

【図9】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第2の工程を示す断面図である。

【図10】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第3の工程を示す断面図である。

【図11】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第4の工程を示す断面図である。

【図12】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第5の工程を示す断面図である。

【図13】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第6の工程を示す断面図である。

【図14】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第7の工程を示す断面図である。

【図15】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第8の工程を示す断面図である。

【図16】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第9の工程を示す断面図である。

【図17】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第10の工程を示す断面図である。

【図18】本発明の薄膜デバイスの転写方法の第2の実施の形態における第11の工程を示す断面図である。

【図19】（a）、（b）は共に、本発明を用いて製造されたマイクロコンピュータの斜視図である。

【図20】液晶表示装置の構成を説明するための図である。

【図21】液晶表示装置の要部の断面構造を示す図である。

【図22】液晶表示装置の要部の構成を説明するための図である。

【図23】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第1の工程を示すデバイスの断面図である。

【図24】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第2の工程を示すデバイスの断面図である。

【図25】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第3の工程を示すデバイスの断面図である。

【図26】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第4の工程を示すデバイスの断面図である。

【図27】本発明を用いたアクティブマトリクス基板の製造方法の第5の工程を示すデバイスの断面図である。

【図28】本発明の薄膜デバイスの転写方法の他の例を説明するための図である。

【図29】本発明の薄膜デバイスの転写方法のさらに他の例を説明するための図である。

【図30】本発明の薄膜デバイスの転写方法の変形例を説明するための図である。

【図31】分離層をアモルファスシリコンにて形成した場合の、アブレーションするに至る経緯の、分離層の光吸収エネルギーと膜厚との相関を示す図である。

【図32】分離層へのビームスキャンの一例を示す平面図である。

【図33】分離層であるアモルファスシリコン層の上に、シリコン系介在層を介して光吸収層となるアモルファスシリコン層を配置した変形例を示す図である。

【図34】分離層の上に、分離層とは異なる材質のシリコン系光吸収層を配置した変形例を示す図である。

【図35】（A）～（E）はそれぞれ、分離層の剥離時に薄膜デバイスの変形または破壊を防止するための補強層を配置した変形例を示す図である。

【符号の説明】

20 (N) N回目のビーム照射領域

30 非照射領域（低照射領域）

100 基板

120 アモルファスシリコン層（レーザー吸収層）

126 シリコン系光吸収層

128 シリコン系介在層

130 シリコン系光吸収層

132 補強層

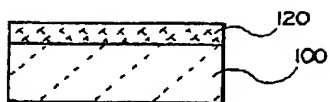
140 薄膜デバイス層

160 接着層

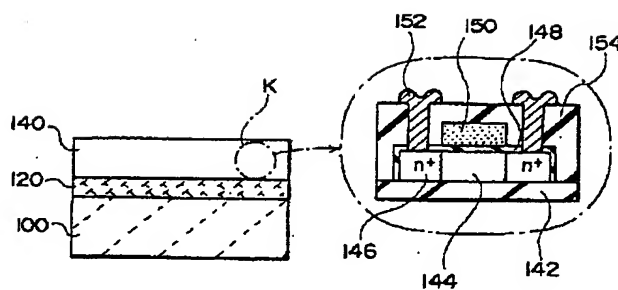
180 転写体



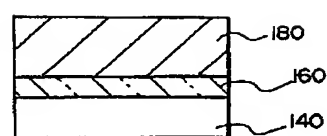
【図 1】



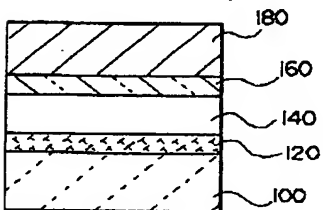
【図 2】



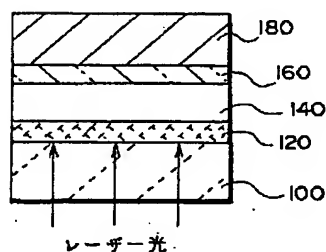
【図 6】



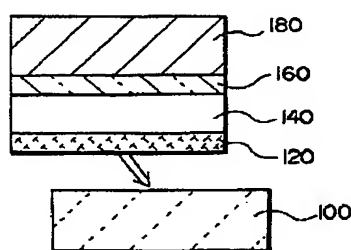
【図 3】



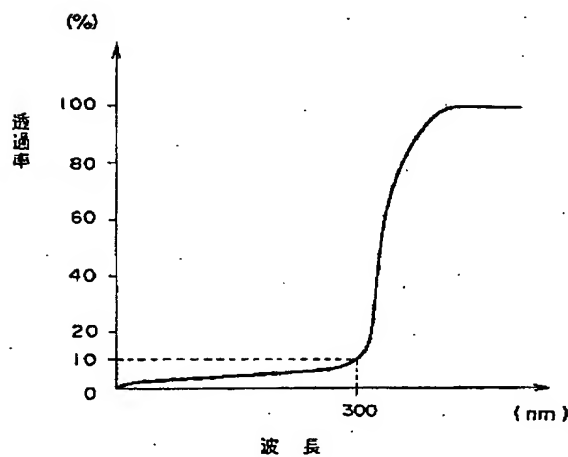
【図 4】



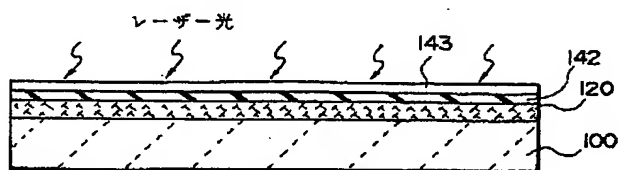
【図 5】



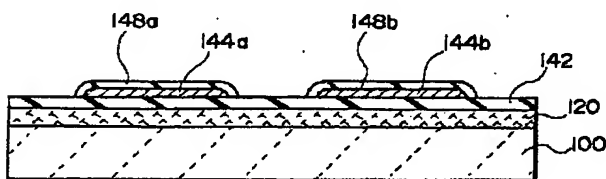
【図 7】



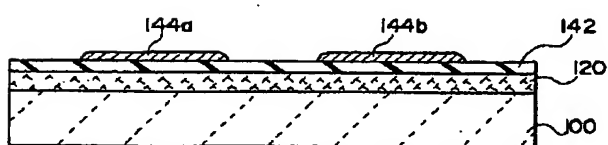
【図 8】



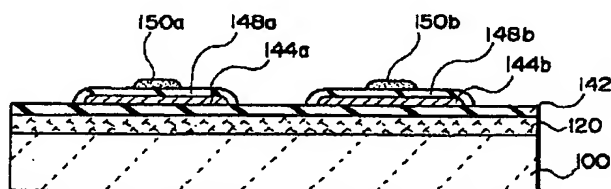
【図 10】



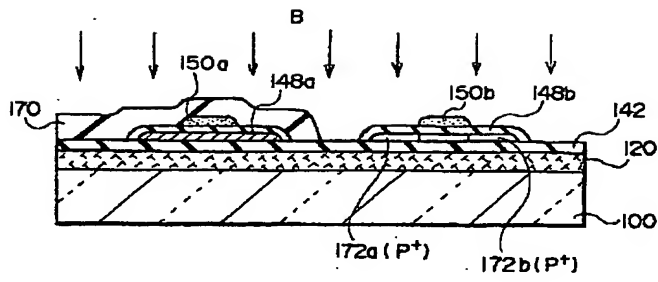
【図 9】



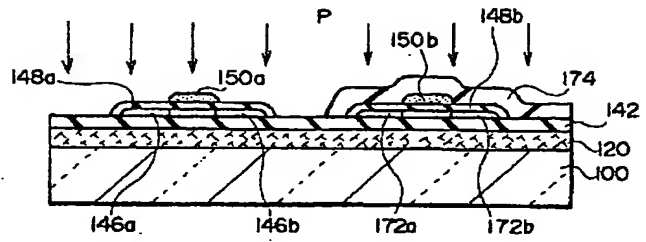
【図 11】



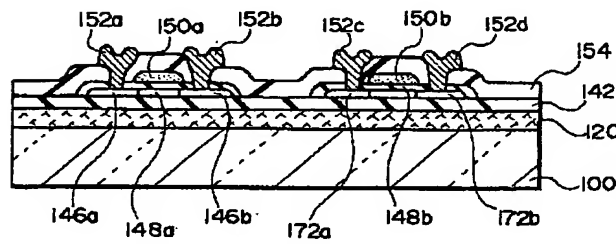
【図 12】



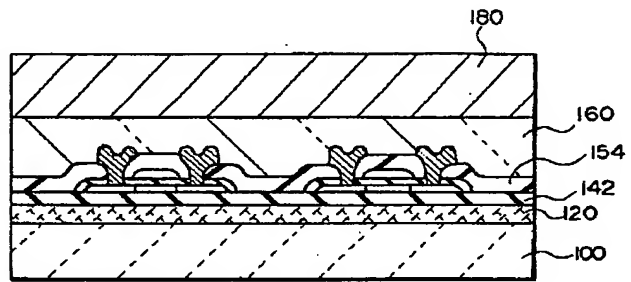
【図 13】



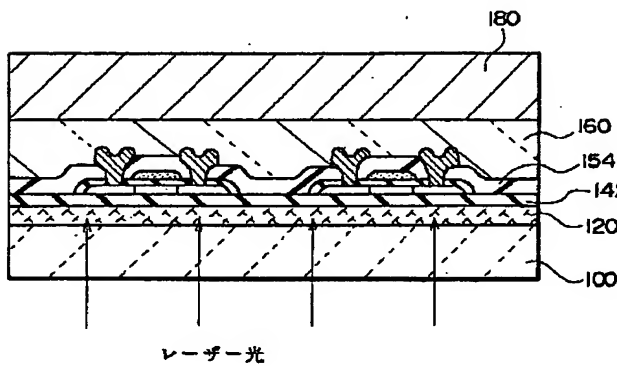
【図 14】



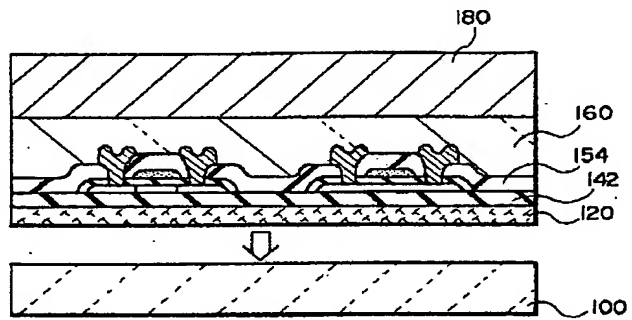
【図 15】



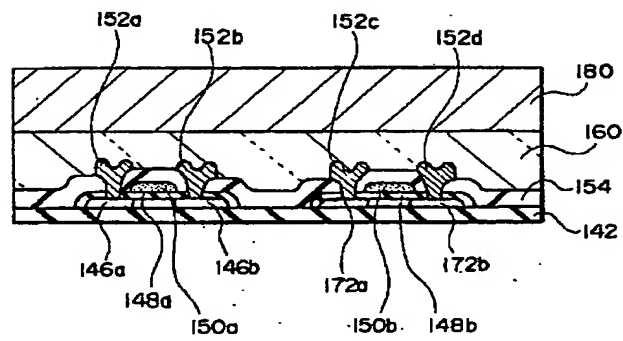
【図 16】



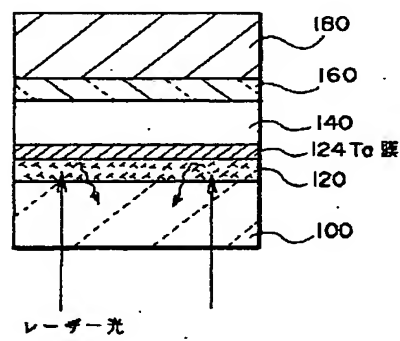
【図 17】



【図 18】

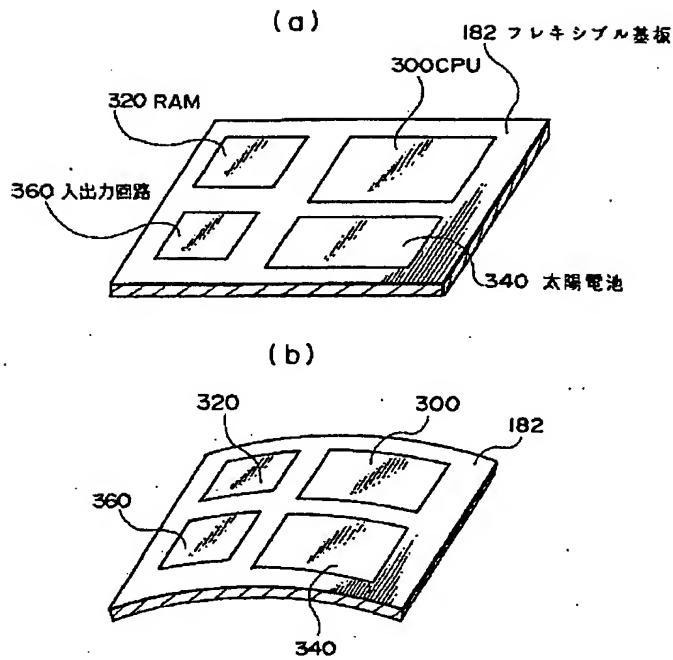


【図 30】

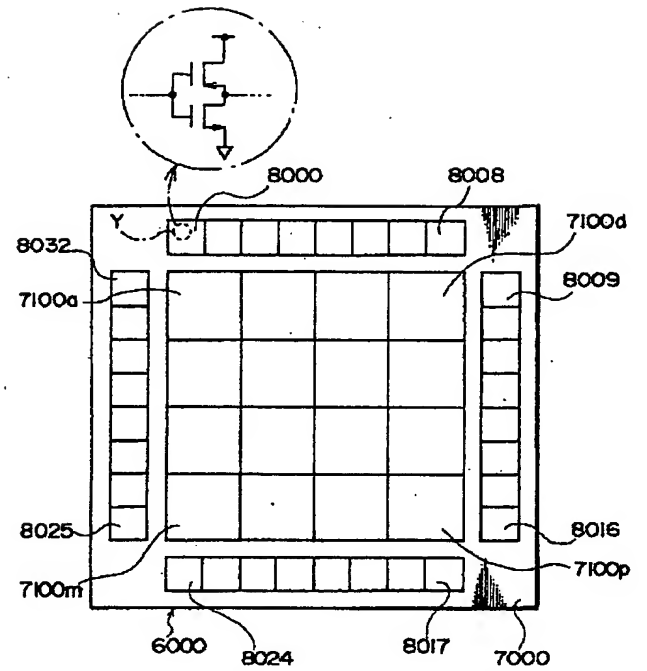




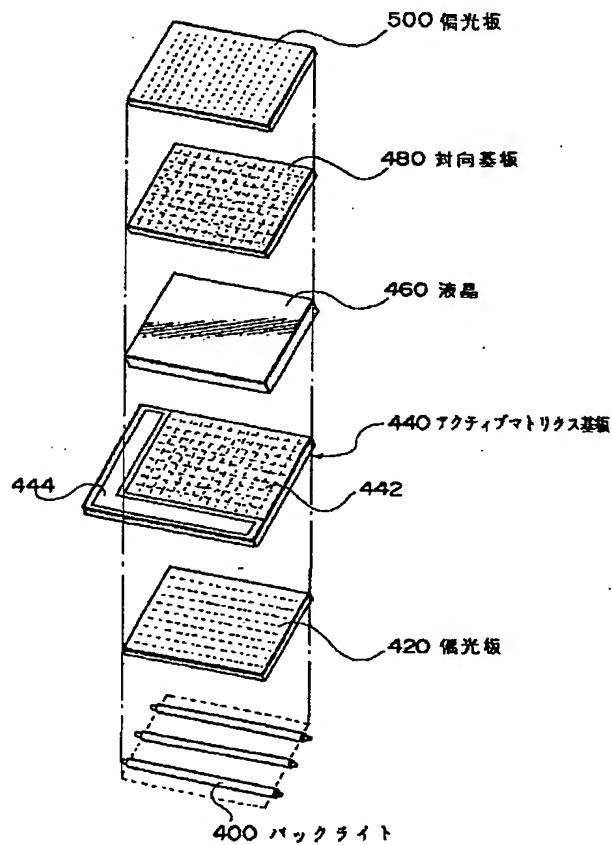
【図 19】



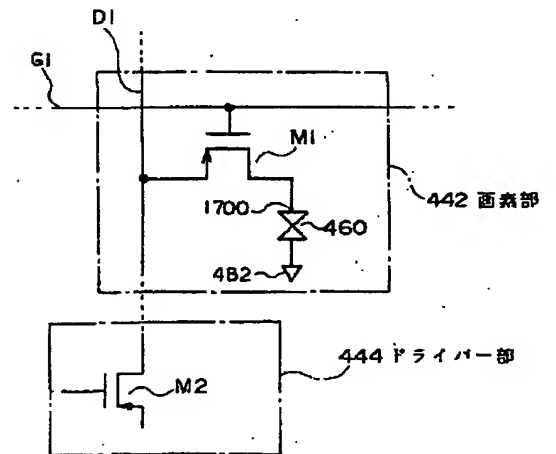
【図 29】



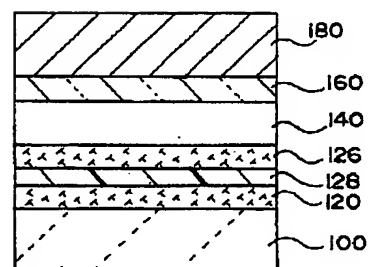
【図 20】



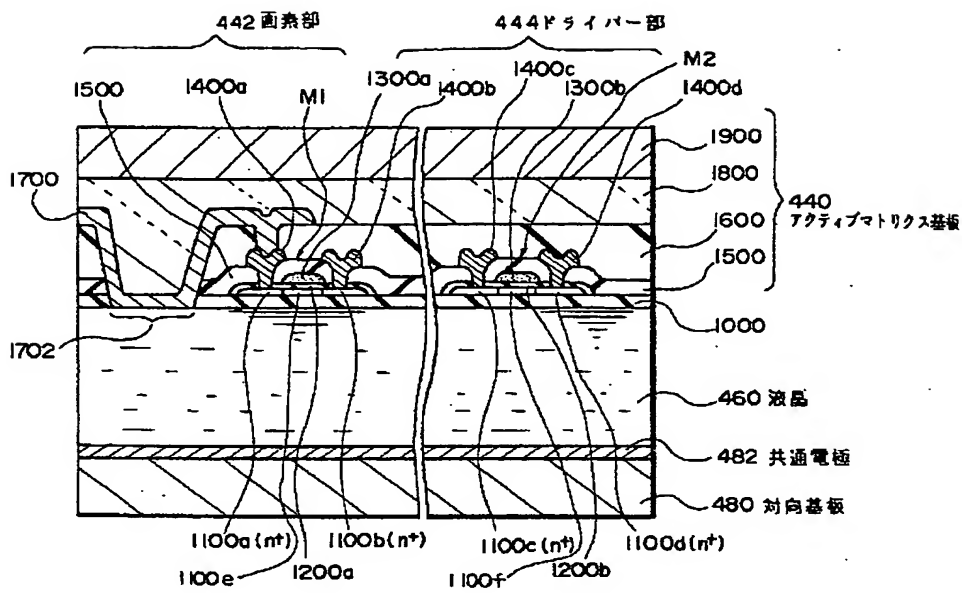
【図 22】



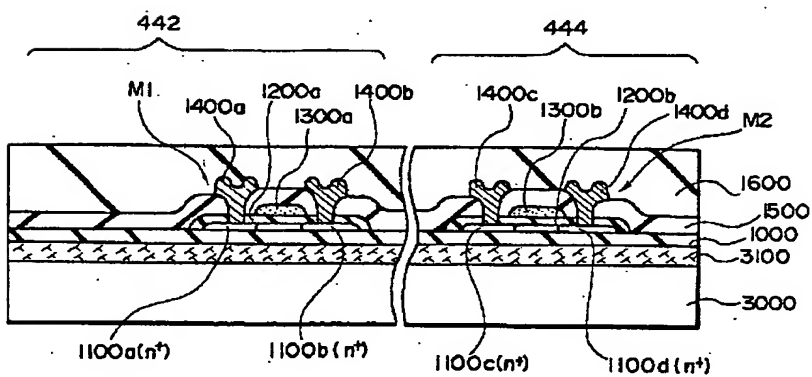
【図 33】



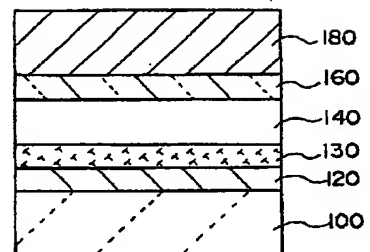
【図21】



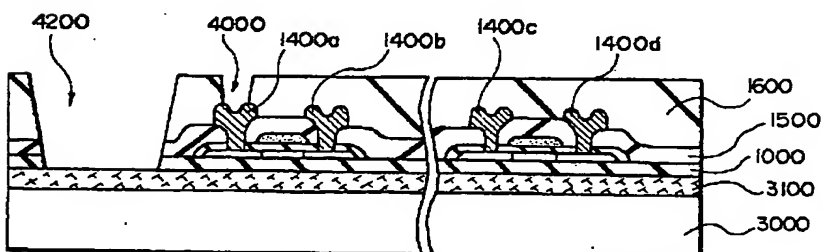
【図23】



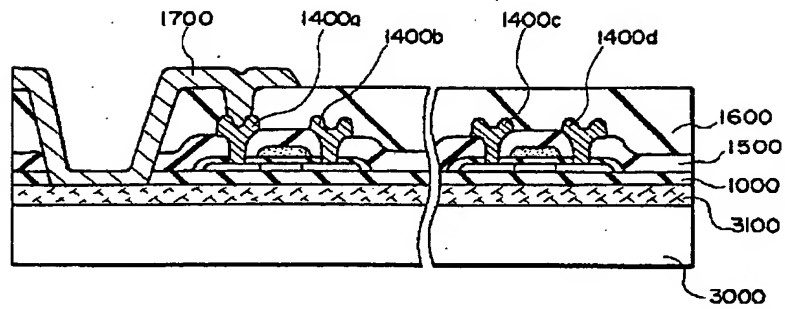
【図34】



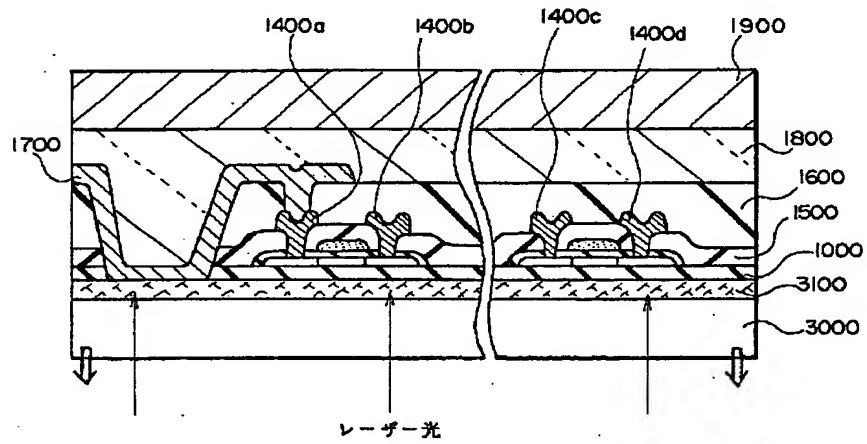
【図24】



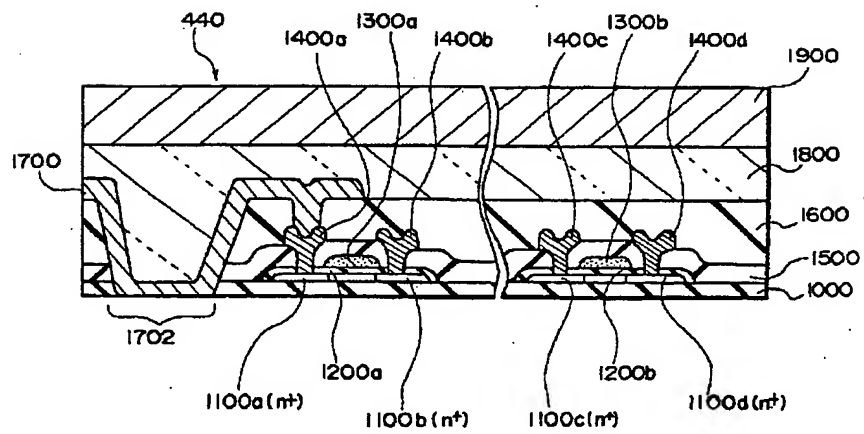
【図 2 5】



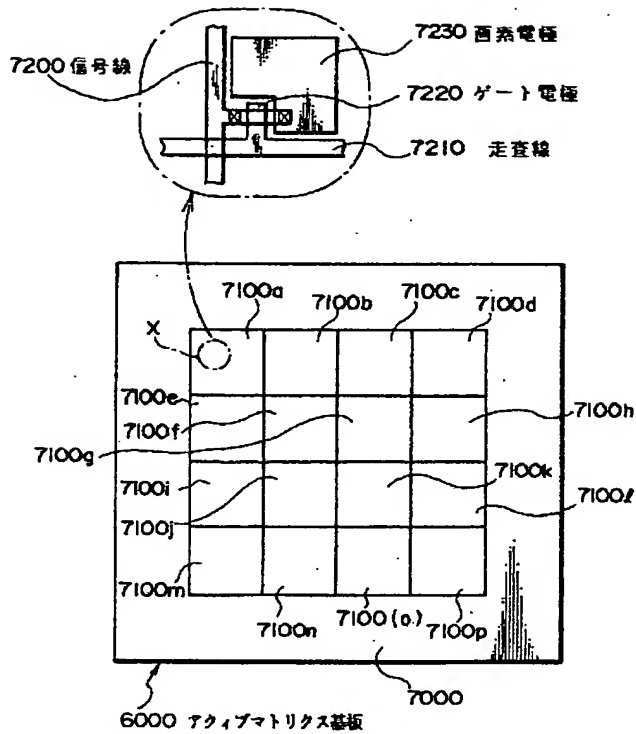
【図 2 6】



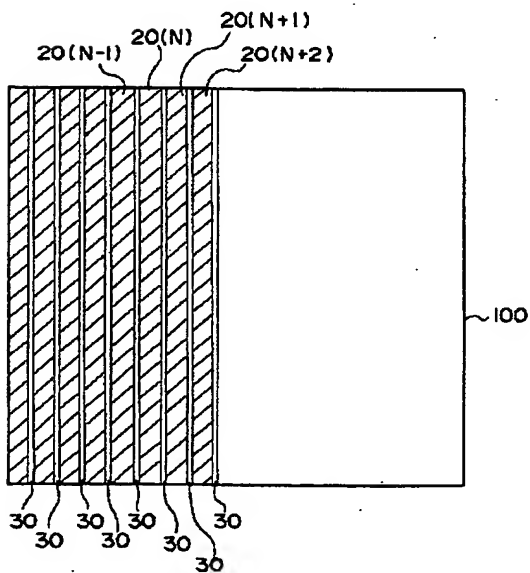
【図 2 7】



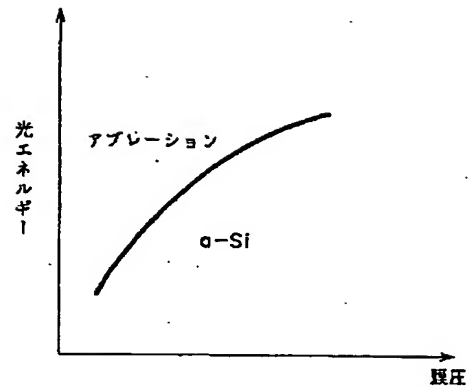
【図 28】



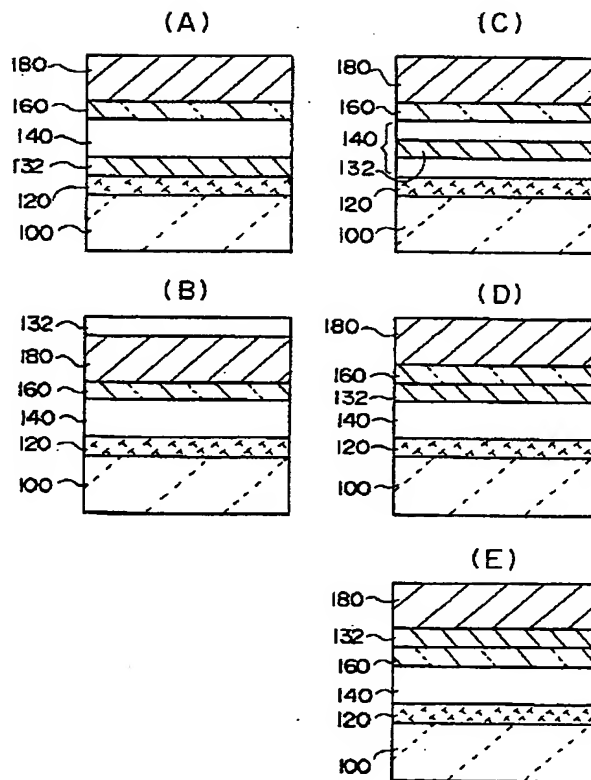
【図 32】



【図 31】



【図 35】



## \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

JP-A 11-074533

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

CLAIMS

---

## [Claim(s)]

[Claim 1] The 1st process which is the method of imprinting the transferred layer containing the thin film device on a substrate on an imprint object, and forms an amorphous silicon layer on the aforementioned substrate, The 2nd process which forms the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on the aforementioned amorphous silicon layer, The 3rd process which joins the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device to the aforementioned imprint object through a glue line, The 4th process at which light is irradiated through the aforementioned substrate at the aforementioned amorphous silicon layer, exfoliation is produced in the inside of the layer of the aforementioned amorphous silicon layer, and/or an interface, and the bonding strength of the aforementioned substrate and the aforementioned transferred layer is reduced, The 5th process which makes the aforementioned substrate secede from the aforementioned amorphous silicon layer, The thickness of the aforementioned amorphous silicon layer in which the aforementioned transferred layer which \*\*\*\* and is formed at the 2nd process of the above is formed at the 1st process of the above including TFT The imprint method of the thin film device characterized by being formed more thinly than the thickness of the channel layer of the aforementioned TFT formed at the 2nd process of the above.

[Claim 2] How to imprint the transferred layer containing the thin film device on a substrate characterized by providing the following on an imprint object. The 1st process which forms an amorphous silicon layer in thickness 25nm or less on the aforementioned substrate. The 2nd process which forms the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on the aforementioned amorphous silicon layer. The 3rd process which joins the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device to the aforementioned imprint object through a glue line. The 4th process at which light is irradiated through the aforementioned substrate at the aforementioned amorphous silicon layer, exfoliation is produced in the inside of the layer of the aforementioned amorphous silicon layer, and/or an interface, and the bonding strength of the aforementioned substrate and the aforementioned transferred layer is reduced, and the 5th process which makes the aforementioned substrate secede from the aforementioned amorphous silicon layer.

[Claim 3] The imprint method of the thin film device characterized by forming the thickness of the aforementioned amorphous silicon layer in thickness 11nm or less at the 2nd process of the above in a claim 2.

[Claim 4] The imprint method of the thin film device characterized by forming the aforementioned amorphous silicon layer in a low voltage vapor growth at the 2nd process of the above in a claim 1 or either of 3.

[Claim 5] How to imprint the transferred layer containing the thin film device on a substrate characterized by providing the following on an imprint object. The process which forms a detached core on the aforementioned substrate. The process which forms a silicon system optical-absorption layer on the aforementioned detached core. The process which forms the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on the aforementioned silicon system optical-absorption



layer. The process which joins the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device to the aforementioned imprint object through a glue line, the process which light is irradiated [ process ] through the aforementioned substrate at the aforementioned detached core, and produces exfoliation in the inside of the layer of the aforementioned detached core, and/or an interface, and the process which makes the aforementioned substrate secede from the aforementioned detached core.

[Claim 6] It is the imprint method of the thin film device characterized by establishing further the process which the aforementioned detached core and the aforementioned optical-absorption layer are formed in an amorphous silicon in a claim 5, and forms the intervention layer of a silicon system between the aforementioned detached core and the aforementioned optical-absorption layer.

[Claim 7] The 1st process which is the method of imprinting the transferred layer containing the thin film device on a substrate on an imprint object, and forms a detached core on the aforementioned substrate, The 2nd process which forms the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on the aforementioned detached core, The 3rd process which joins the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device to the aforementioned imprint object through a glue line, The 4th process which light is irradiated [ process ] through the aforementioned substrate at the aforementioned detached core, and produces exfoliation in the inside of the layer of the aforementioned detached core, and/or an interface, It has the 5th process which makes the aforementioned substrate secede from the aforementioned detached core. at the 4th process of the above The imprint method of the thin film device characterized by catching the stress which acts on the upper layer of the aforementioned detached core when exfoliation is produced in the inside of the layer of the aforementioned detached core, and/or an interface with the proof stress which the upper layer of the aforementioned detached core has, and preventing deformation or destruction of the upper layer of the aforementioned detached core.

[Claim 8] The imprint method of the thin film device characterized by having further the process which forms the reinforcement layer for securing the aforementioned proof stress in a claim 7 in one of the positions which serves as the upper layer of the aforementioned detached core before operation of the 4th process of the above.

[Claim 9] The imprint method of the thin film device which carries out multiple-times execution of the imprint method according to claim 1 to 8, and is characterized by imprinting two or more transferred layers on the aforementioned larger imprint object than the aforementioned substrate in a claim 1 or either of 8.

[Claim 10] The imprint method of the thin film device which carries out multiple-times execution of the imprint method according to claim 1 to 8, and is characterized by imprinting two or more transferred layers from which the level of the design rule of a thin film device differs on the aforementioned imprint object in a claim 1 or either of 8.

[Claim 11] The thin film device which the aforementioned imprint object comes to imprint using the imprint method according to claim 1 to 10.

[Claim 12] It is the thin film device characterized by the aforementioned thin film device being TFT (TFT) in a claim 11.

[Claim 13] Thin film integrated circuit equipment constituted including the thin film device imprinted by the aforementioned imprint object using the imprint method according to claim 1 to 10.

[Claim 14] The active-matrix substrate which is an active-matrix substrate which the pixel section consists of including the TFT (TFT) arranged in the shape of a matrix, and the pixel electrode connected to the end of the TFT, and was manufactured by imprinting the TFT of the aforementioned pixel section using a method according to claim 1 to 10.

[Claim 15] The active-matrix substrate characterized by providing the following. TFT connected to the scanning line arranged in the shape of a matrix, and a signal line (TFT) TFT which is the active-matrix substrate which builds in the driver circuit for the pixel section being constituted including the pixel electrode connected to the end of the TFT, and supplying a signal to the aforementioned scanning line and the aforementioned signal line, and constitutes the TFT of the aforementioned pixel section of the 1st design rule level formed using the method according to claim 10, and the aforementioned driver





circuit of the 2nd design rule level.

[Claim 16] The liquid crystal display manufactured using the active-matrix substrate according to claim 14 or 15.

---

[Translation done.]



\* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

---

DETAILED DESCRIPTION

---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the imprint method, the thin film device, the thin film integrated circuit equipment, active-matrix substrate, and liquid crystal display of a thin film device.

[0002]

Background of the Invention] For example, it faces manufacturing the liquid crystal display using TFT (TFT), and passes through the process which forms TFT by CVD etc. on a substrate. Since the process which forms TFT on a substrate is accompanied by high temperature processing, a substrate needs to use what has the high thing, i.e., the softening temperature, and the high melting point of the quality of the material which is excellent in thermal resistance. Therefore, quartz glass is used as a substrate which bears the temperature of about 1000 degrees C now, and heat-resisting glass is used as a substrate which bears the temperature around 500 degrees C.

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] As mentioned above, the substrate in which a thin film device is carried must satisfy the conditions for manufacturing those thin film devices. That is, it is determined that the substrate to be used will surely fulfill the manufacture conditions of the device carried.

[0004] However, when its attention is paid only to the stage after the substrate in which thin film devices, such as TFT, were carried is completed, above-mentioned "substrate" is not sometimes necessarily desirable.

[0005] For example, although a quartz substrate, a heat-resisting glass substrate, etc. are used as mentioned above when passing through the manufacture process accompanied by high temperature processing, these are very expensive, therefore cause elevation of a product price.

[0006] Moreover, a glass substrate has the property for it to be heavy and to be easy to be divided. Although what cannot break easily even if it is cheap as much as possible, it is light and it bears and drops also on deformation of some is desirable in the liquid crystal display used for portable electronic equipment, such as a palm top computer and a portable telephone, actually, a glass substrate is heavy, and is weak to deformation, and it is common that there is fear of destruction by fall.

[0007] That is, it was very difficult for a slot to be between the desirable properties required of the restrictions which come from manufacture conditions, and a product, and to satisfy the conditions and property of these both sides to it.

[0008] Then, after this invention person etc. forms the transferred layer containing a thin film device on the 1st substrate in the conventional process, he made the transferred layer containing this thin film device secede from the 1st substrate, and has proposed the technology which the 2nd substrate is made to imprint (Japanese Patent Application No. No. 225643 [ eight to ]). For this reason, the detached core is formed between the 1st substrate and the thin film device which is a transferred layer. It makes it possible to make a transferred layer secede from the 1st substrate by making the inside of the layer of a



detached core, and/or an interface exfoliate, and weakening the bonding strength of the 1st substrate and a transferred layer by irradiating light at this detached core.

[0009] Here, when irradiating light at a detached core according to this invention person's further analysis and the light energy was raised too much, it became clear that the light beyond the energy made sufficient for a detached core producing ablation leaks from a detached core, and carries out incidence to the thin film device of a transferred layer. It became clear that the case where it deteriorates by this optical leakage as compared with the thin film device formed in the 1st substrate, the property, for example, electrical property, of a thin film device imprinted by the 2nd substrate, arises.

[0010] As this property of deteriorating, when TFT was formed, for example as a thin film device, the damage was given to the channel layer, reduction in the ON state current and increase of the OFF state current were caused, and the light which irradiated the detached core in the process which irradiates light traced destroying TFT, when the worst.

[0011] Furthermore, according to this invention person's etc. experiment, the transferred layer which contains a thin film device at the process which makes the inside of the layer of a detached core and/or an interface produce exfoliation might be deformed or destroyed.

[0012] this invention is made in view of the above-mentioned situation. one of the purpose of the With the 1st substrate used at the time of manufacture of a thin film device, for example, the 2nd substrate (substrate with the property desirable in view of the use of a product) used at the time of real use of a product The light energy which it makes it possible to choose freely independently, and is irradiated by the detached core is reduced, and it is in offering the new technology in which the property of the thin film device imprinted by the 2nd substrate is not degraded.

[0013] Even if there is optical leakage from a detached core, the light which leaked will not reach a thin film device, but other purposes of this invention are to offer the new technology which can moreover form the high thin film device of quality using the established thin film coating technology.

[0014] The purpose of further others of this invention is to prevent certainly that the transferred layer which contains a thin film device at the process which makes the inside of the layer of a detached core and/or an interface produce exfoliation is deformed or destroyed, and offer the new technology which can imprint a thin film device to the 2nd substrate.

[0015]

[Means for Solving the Problem] this invention which solves the technical problem mentioned above is carrying out the following composition.

[0016] The 1st process which invention according to claim 1 is the method of imprinting the transferred layer containing the thin film device on a substrate on an imprint object, and forms an amorphous silicon layer on the aforementioned substrate, The 2nd process which forms the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on the aforementioned amorphous silicon layer, The 3rd process which joins the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device to the aforementioned imprint object through a glue line, The 4th process at which light is irradiated through the aforementioned substrate at the aforementioned amorphous silicon layer, exfoliation is produced in the inside of the layer of the aforementioned amorphous silicon layer, and/or an interface, and the bonding strength of the aforementioned substrate and the aforementioned transferred layer is reduced, The 5th process which makes the aforementioned substrate secede from the aforementioned amorphous silicon layer, It \*\*\*\* and thickness of the aforementioned amorphous silicon layer in which the aforementioned transferred layer formed at the 2nd process of the above is formed at the 1st process of the above including TFT is characterized by being formed more thinly than the thickness of the channel layer of the aforementioned TFT formed at the 2nd process of the above.

[0017] For example, the detached core which has the property which absorbs light that the reliability in device manufacture is high, on substrates, such as a quartz substrate, is prepared, and thin film devices, such as TFT, are formed on the substrate. Next, although not limited especially, it joins to the imprint object of a request of a thin film device, for example through a glue line, light is irradiated after that at a detached core, it produces and cheats out of an exfoliation phenomenon in the detached core by this, and the adhesion between the detached core and aforementioned substrate is reduced. And the force is



applied to a substrate and the substrate is made to secede from a thin film device. By this, a desired reliable device can be imprinted on any imprint objects (formation).

[0018] Here, in invention of a claim 1, the amorphous silicon layer is used as a layer which is formed on a substrate at the 1st process and produces exfoliation by optical irradiation at the 4th process. This amorphous silicon layer can make small a light energy required to carry out optical irradiation at this amorphous silicon layer, and produce exfoliation (for ablation to be called in drawing 31 ), so that thickness becomes thin, as shown in drawing 31 .

[0019] Here, the transferred layer formed at the 2nd process contains TFT as a thin film device, and the channel layer is formed in silicon layers, such as contest polysilicon or an amorphous silicon, and is formed in the about 50nm thickness exceeding 25nm generally. In invention of a claim 1, the thickness of the amorphous silicon as a detached core (ablation layer) formed at the 1st process is formed more thinly than the channel layer of the TFT in a transferred layer. Therefore, while the consumption energy in an optical irradiation process decreases, the miniaturization of the light equipment used for it can be attained. Furthermore, since there are few light energies irradiated, even if it should carry out optical leakage from an amorphous silicon layer and the light which leaked carries out incidence to a thin film device, degradation of the property of a thin film device reduces only a part with few light energies.

[0020] Invention of a claim 2 is replaced with the definition of the thickness of the amorphous silicon layer in invention of a claim 1, and defines the thickness of this layer as 25nm or less.

[0021] If it is the thickness which the light energy required to carry out optical irradiation at this amorphous silicon layer, and produce exfoliation could be made small, and defined it by the claim 2, a light energy can be made sufficiently small, so that thickness becomes thin as are mentioned above, and an amorphous silicon layer is shown in drawing 31 . In addition, if the thickness range of an amorphous silicon layer is set to 11nm or less as being referred to as 5-25nm shows 15nm or less or a claim 3 desirable still more preferably, it can make still smaller a light energy required to carry out optical irradiation at an amorphous silicon layer, and produce exfoliation.

[0022] Invention of a claim 4 is characterized by forming the aforementioned amorphous silicon layer in a low voltage vapor growth (LPCVD) at the 2nd process of the above in a claim 1 or either of 3.

[0023] if an amorphous silicon layer is formed in LPCVD -- plasma CVD and atmospheric pressure (AP) -- as compared with CVD, efficient consumer response, etc., adhesion is high, and in case the transferred layer containing the aforementioned thin film device is formed, there is little risk of hydrogen occurring and defects, such as film peeling, occurring

[0024] The process which invention of a claim 5 is the method of imprinting the transferred layer containing the thin film device on a substrate on an imprint object, and forms a detached core on the aforementioned substrate, The process which forms a silicon system optical-absorption layer on the aforementioned detached core, and the process which forms the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on the aforementioned silicon system optical-absorption layer, The process which joins the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device to the aforementioned imprint object through a glue line, Light is irradiated through the aforementioned substrate at the aforementioned detached core, and it is characterized by having the process which produces exfoliation in the inside of the layer of the aforementioned detached core, and/or an interface, and the process which makes the aforementioned substrate secede from the aforementioned detached core.

[0025] According to invention of a claim 5, even if it should carry out optical leakage from a detached core, before carrying out incidence of the light which leaked to a thin film device, it is absorbed by the silicon system optical-absorption layer. Therefore, it can prevent certainly that light carries out incidence to a thin film device, and degradation of the property of the thin film device resulting from optical incidence can be prevented. And the transferred layer containing a thin film device can be formed on a silicon system optical-absorption layer. For this reason, light

[0026] Invention of a claim 6 is characterized by establishing further the process which the aforementioned detached core and the aforementioned optical-absorption layer are formed in an amorphous silicon, and forms the intervention layer of a silicon system between the aforementioned





detached core and the aforementioned optical-absorption layer in a claim 5.

[0027] According to invention of a claim 6, the amorphous silicon layer which exfoliates when the irradiated light is absorbed and the light energy becomes beyond a predetermined value, as drawing 31 showed is used as a detached core and a silicon system optical-absorption layer. The silicon system, for example, a silicon oxide, is used as an intervention layer for separating this two-layer amorphous silicon layer.

[0028] The 1st process which invention of a claim 7 is the method of imprinting the transferred layer containing the thin film device on a substrate on an imprint object, and forms a detached core on the aforementioned substrate, The 2nd process which forms the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device on the aforementioned detached core, The 3rd process which joins the aforementioned transferred layer containing the aforementioned thin film device to the aforementioned imprint object through a glue line, The 4th process which light is irradiated [ process ] through the aforementioned substrate at the aforementioned detached core, and produces ablation in the inside of the layer of the aforementioned detached core, and/or an interface, It has the 5th process which makes the aforementioned substrate secede from the aforementioned detached core. at the 4th process of the above It is characterized by catching the stress which acts on the upper layer of the aforementioned detached core when ablation is produced in the inside of the layer of the aforementioned detached core, and/or an interface with the proof stress which the upper layer of the aforementioned detached core has, and preventing deformation or destruction of the upper layer of the aforementioned detached core.

[0029] It is excited photochemistry-wise [ the matter which constitutes a detached core from this 4th process if optical irradiation is carried out ], or thermally, combination of the molecule of the front face and interior or an atom is cut, and this molecule or an atom is emitted outside. This phenomenon appears as a phenomenon in which all or some of matter which constitutes a detached core mainly produces phase changes, such as melting and evapotranspiration (evaporation). At this time, stress acts on the upper layer of a detached core with discharge of the above-mentioned molecule or an atom.

[0030] However, this stress is caught by the proof stress which the upper layer of a detached core has, and deformation or destruction of the upper layer of a detached core is prevented.

[0031] What is necessary is just to design the quality of the material and/or thickness of a composition layer which constitute the upper layer of a detached core in consideration of such proof stress. For example, one or more of the quality of the material of the thickness of a glue line, transferred layer thickness, and an imprint object and the thickness are set up in consideration of the above-mentioned proof stress.

[0032] Invention of a claim 8 is characterized by having further the process which forms the reinforcement layer for securing the aforementioned proof stress in one of the positions which serves as the upper layer of the aforementioned detached core before operation of the 4th process of the above in a claim 7.

[0033] Only with the glue line, transferred layer, and imprint object which are the minimum composition layer which constitutes the upper layer of a detached core from invention of a claim 8, when the above-mentioned proof stress cannot be secured, deformation of a thin film device and destruction can be prevented by adding a reinforcement layer.

[0034] In addition, in invention of claims 1-8, the process which joins a thin film device (transferred layer containing a thin film device) to an imprint object through a glue line, and the process which makes a substrate secede from a thin film device may not ask the sequence, but the point is sufficient as any. However, when a problem is in handling of the thin film device (transferred layer containing a thin film device) after making it secede from a substrate, it is desirable to carry out first the process which joins a thin film device to an imprint object, and to carry out the process made to secede from a substrate after that.

[0035] Moreover, if the matter (for example, thermosetting resin) with planation is used as a glue line used for junction on the imprint object of a thin film device, though some level differences have arisen on the front face of the transferred layer containing a thin film device, flattening of the level difference is carried out, and it can ignore, and it becomes joinable to an imprint object good therefore always, and



is convenient.

[0036] It is desirable to have further the process which removes the aforementioned detached core adhering to the aforementioned imprint object.

[0037] An unnecessary detached core is removed completely.

[0038] Here, if reference is made about the good better quality of the material of an imprint object, a property, etc., as for the aforementioned imprint object, it is desirable first that it is a transparent substrate.

[0039] As this transparent substrate, a substrate for example, with a cheap soda-glass substrate etc., the transparent plastic film which has flexibility can be mentioned. A transparent substrate, then the imprint object with which this was imprinted when the thin film device was TFT, for example can be used as a substrate for liquid crystal panels.

[0040] Moreover, when the maximum temperature in the case of formation of a transferred layer is set to  $T_{max}$ , as for the aforementioned imprint object, it is desirable that a glass transition point ( $T_g$ ) or softening temperature consists of material below  $T_{max}$ .

[0041] The maximum temperature at the time of device manufacture cannot be borne, but it is because the cheap glass substrate which has not been used can be used freely conventionally.

[0042] According to this invention, a glass transition point ( $T_g$ ) or softening temperature may be below the maximum temperature of the formation process of the aforementioned thin film device, because the aforementioned imprint object is because an imprint object is not exposed to the maximum temperature at the time of formation of a thin film device.

[0043] The aforementioned imprint object can consist of synthetic resin or glass material.

[0044] For example, if a thin film device is imprinted to the synthetic-resin board which has pliability (flexibility), such as plastic film, in a rigid high glass substrate, an outstanding property which is not acquired is realizable. If this invention is applied to a liquid crystal display, a pliant and light and display unit strong also against fall will be realized.

[0045] Moreover, for example, a substrate with a cheap soda-glass substrate etc. can also be used as an imprint object. A soda-glass substrate is a low price and is an advantageous substrate economically. The soda-glass substrate had the problem that an alkali component was eluted with heat treatment at the time of TFT manufacture, and application to an active-matrix type liquid crystal display was difficult conventionally. However, in order to imprint the already completed thin film device according to this invention, the problem accompanying above-mentioned heat treatment is solved. Therefore, in the field of an active-matrix type liquid crystal display, it becomes usable [ a substrate with the conventional problems, such as a soda-glass substrate ].

[0046] Next, if reference is made about the quality of the material of the substrate in which a detached core and a transferred layer are formed, a property, etc., as for the aforementioned translucency substrate, it is desirable to have thermal resistance.

[0047] It is because desired high temperature processing becomes possible at the time of manufacture of a thin film device and a thin film device with it can be manufactured. [ it is reliable and highly efficient ]

[0048] Moreover, as for the aforementioned substrate, it is desirable to penetrate 310nm light 10% or more. At this time, the light containing the wavelength of 310nm is irradiated at the aforementioned optical irradiation process.

[0049] The light energy made sufficient for producing ablation in a detached core is efficiently performed through a substrate.

[0050] Next, when the desirable quality of the material of a detached core, a property, etc. are explained, as for the aforementioned detached core, it is desirable to consist of amorphous silicons.

[0051] An amorphous silicon absorbs light, and the manufacture is also easy the amorphous silicon, and its practicality is high.

[0052] Furthermore, as for the aforementioned amorphous silicon, it is desirable to contain hydrogen (H) more than 2 atom %.

[0053] When the amorphous silicon containing hydrogen is used, hydrogen is emitted with irradiation of



light and there is an operation which produces internal pressure in a detached core and stimulates the ablation in a detached core by this.

[0054] Or the aforementioned amorphous silicon can contain hydrogen (H) more than 10 atom %.

[0055] When the content of hydrogen increases, the operation to which the ablation in a detached core is urged becomes more remarkable.

[0056] A silicon nitride can be mentioned as other quality of the materials of a detached core.

[0057] A hydrogen content alloy can be mentioned as the quality of the material of further others of a detached core.

[0058] If a hydrogen content alloy is used as a detached core, hydrogen will be emitted with irradiation of light and the ablation in a detached core will be promoted by this.

[0059] A nitrogen content metal alloy can be mentioned as the quality of the material of further others of a detached core.

[0060] If a nitrogen content alloy is used as a detached core, nitrogen will be emitted with irradiation of light and the ablation in a detached core will be promoted by this.

[0061] Also let this detached core be a multilayer.

[0062] It shows clearly not to be limited to a monolayer.

[0063] This multilayer can consist of an amorphous silicon film and a metal membrane formed on it.

[0064] As the quality of the material of further others of a detached core, even if there are few ceramics, metals, and organic polymeric materials, it can constitute from a kind.

[0065] A thing actually usable as a detached core is illustrated collectively. As a metal, a hydrogen content alloy and a nitrogen content alloy are also usable, for example. In this case, the ablation in a detached core is promoted by discharge of the hydrogen gas and the nitrogen gas accompanying irradiation of light like the case of an amorphous silicon.

[0066] Next, when the light used at an optical irradiation process is explained, it is desirable to use a laser beam.

[0067] A laser beam is a coherent light and suitable for producing ablation in a detached core.

[0068] This laser beam can set the wavelength to 100nm - 350nm.

[0069] By using the laser beam of a light energy by short wavelength, ablation in a detached core can be performed effectively.

[0070] As laser which fulfills above-mentioned conditions, there is an excimer laser, for example. An excimer laser is gas laser in which the laser beam output of the high energy of a short wavelength ultraviolet region is possible, and can output the laser beam of four kinds of typical wavelength by using what combined rare gas (Ar, Kr, Xe) and halogen gas (F<sub>2</sub>, HCl) as a laser medium (XeF=351nm, XeCl=308nm, KrF=248nm, ArF=193nm).

[0071] By irradiation of excimer laser light, it can produce and cheat out of the operation of direct cutting of molecular binding, evaporation of gas, etc. without a thermal effect in the detached core prepared on the substrate.

[0072] As wavelength of a laser beam, 350nm - 1200nm is also employable.

[0073] When making phase changes, such as a gas evolution, evaporation, and sublimation, start and giving a separation property, the laser beam whose wavelength is 350nm - about 1200nm is [ in / a detached core ] also usable.

[0074] Next, if a thin film device is explained, let the aforementioned thin film device be TFT (TFT).

[0075] Highly efficient TFT can be freely imprinted on a desired imprint object (formation). Therefore, it also becomes possible to carry various electronic circuitries on the imprint object.

[0076] In a claim 1 or either of 8, invention according to claim 9 carries out multiple-times execution of the imprint method according to claim 1 to 8, and is characterized by imprinting two or more transferred layers on the aforementioned larger imprint object than the aforementioned translucency substrate.

[0077] The large-scale circuit board which carried the reliable thin film device can be created by repeating and using a reliable substrate or carrying out multiple-times execution of the imprint of a thin film pattern using two or more substrates.

[0078] In a claim 1 or either of 8, invention according to claim 10 carries out multiple-times execution



of the imprint method according to claim 1 to 8, and is characterized by imprinting two or more transferred layers from which the level of the design rule of a thin film device differs on the aforementioned imprint object.

[0079] When it carries two or more circuits (functional block etc. is included) where kinds differ on one substrate, according to the property required of each circuit, the element used for every circuit may differ from the size (what is called design rule, i.e., a design rule) of wiring. Also in this case, if the imprint is performed for every circuit using the imprint method of this invention, two or more circuits where design rule level differs are realizable on one substrate.

[0080] Invention according to claim 11 is a thin film device which the aforementioned imprint object comes to imprint using the imprint method according to claim 1 to 10.

[0081] Using the imprint technology (imprint technology of a diaphragm structure) of the thin film device of this invention, it is the thin film device formed on arbitrary substrates, and can prevent or reduce that the property of the thin film device deteriorates by improvement of the optical irradiation process for exfoliating a detached core.

[0082] Invention according to claim 12 is characterized by the aforementioned thin film device being TFT (TFT) in a claim 11.

[0083] Invention according to claim 13 is thin film integrated circuit equipment constituted including the thin film device imprinted by the aforementioned imprint object using the imprint method according to claim 1 to 10.

[0084] For example, it is also possible to carry the single chip microcomputer constituted by using TFT (TFT) on the synthetic-resin substrate.

[0085] Invention according to claim 14 is an active-matrix substrate which the pixel section consists of including the TFT (TFT) arranged in the shape of a matrix, and the pixel electrode connected to the end of the TFT, and is the active-matrix substrate manufactured by imprinting the TFT of the aforementioned pixel section using a method according to claim 1 to 10.

[0086] It is the active-matrix substrate which comes to form the pixel section on a desired substrate using the imprint technology (imprint technology of a diaphragm structure) of the thin film device of this invention. Since the restrictions which come from manufacture conditions are eliminated and a substrate can be chosen freely, it is also possible to realize the new active-matrix substrate which is not in the former.

[0087] The TFT connected to the scanning line by which invention according to claim 15 has been arranged in the shape of a matrix, and a signal line (TFT), The pixel section is constituted including the pixel electrode connected to the end of the TFT. And it is the active-matrix substrate which builds in the driver circuit for supplying a signal to the aforementioned scanning line and the aforementioned signal line. It is an active-matrix substrate possessing the TFT which constitutes the TFT of the aforementioned pixel section of the 1st design rule level formed using the method according to claim 10, and the aforementioned driver circuit of the 2nd design rule level.

[0088] On an active-matrix substrate, not only the pixel section but a driver circuit is carried, and, moreover, it is the active-matrix substrate from which the design rule level of a driver circuit and the design rule level of the pixel section differ. For example, if the thin film pattern of a driver circuit is formed using the manufacturing installation of Silicon TFT, it is possible to raise a degree of integration.

[0089] Invention according to claim 16 is the liquid crystal display manufactured using the active-matrix substrate according to claim 14 or 15.

[0090] For example, the liquid crystal display with the property at which it turns flexibly using the plastic plate is also realizable.

[0091]

[Embodiments of the Invention] Next, the gestalt of operation of this invention is explained with reference to a drawing.

[0092] (Gestalt of the 1st operation) Drawing 1 - drawing 6 are drawings for explaining the gestalt (the imprint method of a thin film device) of operation of the 1st of this invention.





[0093] As shown in [process 1] drawing 1 , a detached core (optical-absorption layer) 120 is formed on a substrate 100.

[0094] Hereafter, a substrate 100 and a detached core 120 are explained.

[0095] \*\* As for the explanation substrate 100 about a substrate 100, it is desirable that it is what has the translucency which light may penetrate.

[0096] In this case, as for the permeability of light, it is desirable that it is 10% or more, and it is more desirable that it is 50% or more. When this permeability is too low, attenuation (loss) of light becomes large and needs the big quantity of light by exfoliating a detached core 120.

[0097] Moreover, as for a substrate 100, it is desirable to consist of reliable material, and it is desirable to consist of material which was excellent in thermal resistance especially. It is because the width of face of a setup of membrane formation conditions, such as the temperature condition, will spread also in that case on the occasion of formation of the transferred layer 140 grade to a substrate 100 top if the substrate 100 is excellent in thermal resistance, although the reason has what process temperature becomes high in case the transferred layer 140 and interlayer 142 who mention later are formed (for example, about 350-1000 degrees C) depending on the kind and formation method.

[0098] Therefore, a substrate 100 has a desirable consisting-of [ the strain point ]-material more than Tmax thing, when the maximum temperature in the case of formation of the transferred layer 140 is set to Tmax. Specifically, a thing 350 degrees C or more has a desirable strain point, and the component of a substrate 100 has a more desirable thing 500 degrees C or more. As such a thing, the heat resisting glass of quartz glass, Corning 7059, and NEC glass OA-2 grade is mentioned, for example.

[0099] Moreover, although especially the thickness of a substrate 100 is not limited, usually, it is desirable that it is about 0.1-5.0mm, and it is more desirable that it is about 0.5-1.5mm. If the thickness of a substrate 100 is too thin, a strong fall will be caused, and if too thick, the permeability of a substrate 100 will become easy to produce attenuation of light in a low case. In addition, when the permeability of the light of a substrate 100 is high, the thickness may exceed the aforementioned upper limit. In addition, as for the thickness of a substrate 100, it is desirable that it is uniform so that light can be irradiated uniformly.

[0100] \*\* As for the explanation detached core 120 of a detached core 120, what the light irradiated is absorbed, it has a property which produces ablation (henceforth "ablation in a layer", and "interfacial peeling") in the inside of the layer and/or an interface, and it arises preferably that the bonding strength between the atoms of the matter which constitutes a detached core 120, or between molecules disappears or decreases by irradiation of light, i.e., ablation, and results in the ablation in a layer and/or interfacial peeling is good.

[0101] Furthermore, a gas may be emitted by irradiation of light from a detached core 120, and the separation effect may be discovered. That is, a detached core 120 absorbs light, it becomes a gas to the case where the component contained in the detached core 120 serves as a gas, and it is emitted for a moment, the steam is emitted, and it may contribute to separation. As composition of such a detached core 120, what is indicated by the following A-E is mentioned, for example.

[0102] A. Amorphous silicon (a-Si)

Hydrogen (H) may contain in this amorphous silicon. In this case, as for the content of H, it is desirable that it is a grade more than 2 atom %, and it is more desirable that it is a 2 - 20 atom % grade. Thus, if specified quantity content of the hydrogen (H) is carried out, hydrogen will be emitted by irradiation of light, internal pressure will occur in a detached core 120, and it will become the force in which it exfoliates an up-and-down thin film. The content of the hydrogen in an amorphous silicon (H) can be adjusted by setting up suitably conditions, such as membrane formation conditions, for example, the gas composition in CVD, gas pressure, gas atmosphere, a quantity of gas flow, temperature, substrate temperature, and injection power.

[0103] B. As various oxide ceramics, such as silicon oxide or a silicic-acid compound, titanium oxide or a titanate-acid compound, a zirconium oxide or a zirconic acid compound, a lanthanum trioxide, or a lanthanum oxidization compound, \*\*\*\*\* (ferroelectric), or semiconductor silicon oxide, SiO, SiO<sub>2</sub>, and Si<sub>3</sub>O<sub>2</sub> are mentioned, and K<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>, Li<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>, CaSiO<sub>3</sub> and ZrSiO<sub>4</sub>, and Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> are mentioned as



a silicic-acid compound, for example.

[0104] TiO, Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, and TiO<sub>2</sub> mention as titanium oxide -- having -- as a titanate-acid compound -- BaTiO<sub>4</sub>, BaTiO<sub>3</sub>, Ba<sub>2</sub>Ti<sub>9</sub>O<sub>20</sub>, BaTi<sub>5</sub>O<sub>11</sub>, and CaTiO<sub>3</sub>, SrTiO<sub>3</sub>, PbTiO<sub>3</sub>, MgTiO<sub>3</sub>, ZrTiO<sub>2</sub>, SnTiO<sub>4</sub> and aluminum<sub>2</sub> -- TiO<sub>5</sub> and FeTiO<sub>3</sub> are mentioned

[0105] As a zirconium oxide, ZrO<sub>2</sub> is mentioned and BaZrO<sub>3</sub>, ZrSiO<sub>4</sub>, PbZrO<sub>3</sub>, MgZrO<sub>3</sub>, and K<sub>2</sub>ZrO<sub>3</sub> are mentioned as a zirconic acid compound, for example.

[0106] C. Ceramics or dielectrics (ferroelectric), such as PZT, PLZT, PLLZT, and PBZT

D. As nitride ceramic E. organic polymeric-materials organic polymeric materials, such as a silicon nitride, nitriding aluminum, and a titanium nitride - CH-, -CO- (Ketone), -CONH- (Amide), -NH- (Imide), - What thing may be used, as long as it has many these combination especially, what has combination (these combination is cut by irradiation of light) of COO- (ester), -N=N- (azo), -CH=N- (CIF), etc., and. Moreover, organic polymeric materials may have an aromatic hydrocarbon (1, two or more benzene rings, or condensed ring of those) in a constructive mood.

[0107] As an example of such organic polymeric materials, polyethylene, a polyolefine like polypropylene, a polyimide, a polyamide, polyester, a polymethylmethacrylate (PMMA), polyphenylene sulfide (PPS), polyether sulphone (PES), an epoxy resin, etc. are raised.

[0108] F. As a metal metal, the alloy containing at least one of aluminum, Li, Ti, Mn, In, Sn, Y, La, Ce, Nd, Pr, Gd, Sm, or sorts of these is mentioned, for example.

[0109] Moreover, although the thickness of a detached core 120 changes with terms and conditions, such as composition of the ablation purpose or a detached core 120, lamination, and the formation method, usually, it is desirable that it is 1nm - about 20 micrometers, it is more desirable that it is 10nm - about 2 micrometers, and it is still more desirable [ thickness ] that it is 40nm - about 1 micrometer. While enlarging power (quantity of light) of light in order to secure the good detachability of a detached core 120, if the homogeneity of membrane formation is spoiled, nonuniformity may arise in ablation, when the thickness of a detached core 120 is too small, and thickness is too thick, in case a detached core 120 is removed behind, the work takes time. In addition, as for the thickness of a detached core 120, it is desirable that it is uniform as much as possible.

[0110] Especially the formation method of a detached core 120 is not limited, but is suitably chosen according to terms and conditions, such as film composition and thickness. For example, it CVD(s) (MOCVD and low voltage -- CVD and efficient consumer response-CVD are included). Vacuum evaporation, molecular-beam vacuum evaporation (MB), sputtering, ion plating, The various gaseous-phase forming-membranes methods, such as PVD, electroplating, immersing plating (dipping), Various plating, such as electroless deposition, the Langmuir pro jet (LB) method, The applying methods, such as a spin coat, a spray coat, and a roll coat, various print processes, a replica method, the ink-jet method, a powder jet process, etc. are mentioned, and it can also form or more [ of these ] combining two.

[0111] In addition, when a detached core 120 is constituted from ceramics by the sol-gel method, or when it constitutes from organic polymeric materials, it is desirable the applying method and to form membranes with a spin coat especially.

[0112] the case where composition of [formation of amorphous silicon layer in process 1] detached core 120 is an amorphous silicon (a-Si) -- a vapor growth (CVD) -- especially -- (low voltage LP) CVD -- plasma CVD and atmospheric pressure (AP) -- CVD and efficient consumer response are excelled

[0113] For example, in the amorphous silicon layer formed of plasma CVD, hydrogen contains comparatively mostly. Although it becomes by existence of this hydrogen that it is easy to carry out ablation of the amorphous silicon layer, if the substrate temperature at the time of membrane formation exceeds 350 degrees C, hydrogen will be emitted from the amorphous silicon layer. Film peeling may arise by the hydrogen from which it secedes in the formation process of this thin film device.

[0114] Moreover, a plasma CVD film has comparatively weak adhesion, and has a possibility that a substrate 100 and the transferred layer 140 may be separated at the wet washing process in a device manufacturing process.

[0115] This point and a LPCVD film do not have a possibility that hydrogen may be emitted, and it excels in the point that moreover sufficient adhesion is securable.



[0116] Next, the thickness of the amorphous silicon layer 120 as a detached core is explained with reference to drawing 31.

[0117] Drawing 31 shows the thickness of an amorphous silicon layer to a horizontal axis, and shows the light energy absorbed by the vertical axis in this layer. As mentioned above, if optical irradiation is carried out, ablation will be produced in an amorphous silicon layer.

[0118] The charge of a bridging (component of a detached core 120) which absorbed irradiation light is excited photochemistry-wise or thermally, ablation means combination of the atom of the front face and interior or a molecule being cut, and emitting here, and it mainly appears as a phenomenon in which all or a part of component of a detached core 120 produces phase changes, such as melting and evapotranspiration (evaporation). Moreover, by the aforementioned phase change, it may be in a minute firing state and bonding strength may decline.

[0119] And drawing 31 shows that an absorbed energy required to reach this ablation is so low that thickness is thin, and ends.

[0120] From the above thing, thickness of the amorphous silicon layer 120 as a detached core is made thin with the form of this operation. The luminous energy irradiated by the amorphous silicon layer 120 can be made small by this, and the miniaturization of light equipment can be attained with energy saving.

[0121] Next, the numeric value of the thickness of the amorphous silicon layer 120 as a detached core is considered. As drawing 31, it turns out that an absorbed energy required to reach ablation is so low that the thickness of an amorphous silicon is thin, and ends, and according to consideration of this invention person, 25nm or less could be desirable and was fully able to produce ablation by the power of common light equipment. Although there is especially no limit about the minimum of thickness, if the minimum is preferably set to 5nm, it will be set from a viewpoint which ensures formation of an amorphous silicon layer and can secure the predetermined adhesion force. Therefore, the suitable range of the thickness of the amorphous silicon layer 120 as a detached core is set to 5-25nm. Still more desirable thickness is 15nm or less, and reservation of the further energy saving and the further adhesion force is obtained. It is 11nm or less, and the most suitable thickness range is this neighborhood, it boils an absorbed energy required for ablation markedly, and can make it low.

[0122] As shown in [a process 2], next drawing 2, the transferred layer (thin film device layer) 140 is formed on a detached core 120.

[0123] The expanded sectional view of K portion (portion shown by surrounding with 1 dotted-line chain line in drawing 2) of this thin film device layer 140 is shown in the right-hand side of drawing 2. As for the thin film device layer 140, it is constituted including TFT (TFT) formed on SiO<sub>2</sub> film (interlayer) 142, and this TFT possesses the source and the drain layer 146 which introduced n type impurity into the polysilicon contest layer, and were formed, the channel layer 144, the gate insulator layer 148, the gate electrode 150, the layer insulation film 154, and the electrode 152 that consists of aluminum so that it may be illustrated.

[0124] Although SiO<sub>2</sub> film is used as an interlayer prepared in contact with a detached core 120 with the form of this operation, the insulator layer of others, such as Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, can also be used. Although the thickness of SiO<sub>2</sub> film (interlayer) is suitably determined according to the formation purpose or the grade of a function which can be demonstrated, usually, it is desirable that it is 10nm - about 5 micrometers, and it is more desirable that it is 40nm - about 1 micrometer. What demonstrates at least one of the functions as the protective layer which an interlayer is formed for the various purpose, for example, protects the transferred layer 140 physically or chemically, an insulating layer, a conductive layer, the shading layer of a laser beam, the barrier layer for migration prevention, and a reflecting layer is mentioned.

[0125] In addition, interlayers, such as SiO<sub>2</sub> film, may not be formed depending on the case, but the direct transferred layer (thin film device layer) 140 may be formed on a detached core 120.

[0126] The transferred layer 140 (thin film device layer) is a layer containing thin film devices, such as TFT as shown in the right-hand side of drawing 2.

[0127] As a thin film device, besides TFT, for example, thin film diode, The optoelectric transducer (the



photosensor, solar battery) and silicon resistance element which consist of PIN junction of silicon, Other thin-film-semiconductor devices, an electrode (example : a transparent electrode like ITO and a mesa film), Actuators, such as a switching element, memory, and a piezoelectric device, a micro mirror (piezo thin film ceramics), There are a micro MAG device which combined a magnetic-recording thin film head, a coil, an inductor, the charge of a thin film quantity magnetic-permiable material, and them, a filter, a reflective film, a dichroic mirror, etc.

[0128] Such a thin film device is a relation with the formation method, and is formed through usually comparatively high process temperature. Therefore, as mentioned above in this case, as a substrate 100, what has high reliability that can bear the process temperature is needed.

[0129] As shown in [a process 3], next drawing 3 , the thin film device layer 140 is joined to the imprint object 180 through a glue line 160 (adhesion).

[0130] As a suitable example of the adhesives which constitute a glue line 160, various hardened type adhesives, such as optical hardening type adhesives, such as reaction hardening type adhesives, heat-hardened type adhesives, and ultraviolet-rays hardening type adhesives, and aversion hardening type adhesives, are mentioned. As composition of adhesives, what thing is sufficient as an epoxy system, an acrylate system, a silicone system, etc., for example. Formation of such a glue line 160 is made for example, by the applying method.

[0131] After applying hardened type adhesives on the transferred layer (thin film device layer) 140 and joining the imprint object 180 on it when using the aforementioned hardened type adhesives for example, the aforementioned hardened type adhesives are stiffened by the hardening method according to the property of hardened type adhesives, and the transferred layer (thin film device layer) 140 and the imprint object 180 are pasted up, and it fixes.

[0132] when adhesives are optical hardening types, light is irradiated from the substrate of light-transmission nature, and both the outsides of an imprint object or -- from one outside of the substrate 100 of light-transmission nature, or the imprint object 180 of light-transmission nature As adhesives, optical hardening type adhesives, such as an ultraviolet-rays hardening type which cannot affect a thin film device layer easily, are desirable.

[0133] In addition, unlike illustration, a glue line 160 may be formed in the imprint object 180 side, and the transferred layer (thin film device layer) 140 may be pasted up on it. In addition, when imprint object 180 the very thing has an adhesion function, for example, you may omit formation of a glue line 160.

[0134] although not limited especially as an imprint object 180 -- a substrate (plate) -- especially a transparent substrate is mentioned In addition, even if such a substrate is monotonous, it may be a curve board. Moreover, compared with the aforementioned substrate 100, properties, such as thermal resistance and corrosion resistance, may be inferior in the imprint object 180. In order that the reason may form the transferred layer (thin film device layer) 140 in a substrate 100 side in this invention and may imprint the transferred layer (thin film device layer) 140 on the imprint object 180 after that, the property required of the imprint object 180, especially thermal resistance are because it is not dependent on the temperature conditions in the case of formation of the transferred layer (thin film device layer) 140 etc.

[0135] Therefore, when the maximum temperature in the case of formation of the transferred layer 140 is set to  $T_{max}$ , a glass transition point ( $T_g$ ) or softening temperature can use the following [  $T_{max}$  ] as a component of the imprint object 0. For example, a glass transition point ( $T_g$ ) or softening temperature can constitute more preferably 800 degrees C or less of 500 degrees C or less of imprint objects 180 from material 320 degrees C or less still more preferably.

[0136] Moreover, although what has a certain amount of rigidity (intensity) as a mechanical property of the imprint object 180 is desirable, you may have flexibility and elasticity. As for the mechanical property of the imprint object 180, it is good to take the following point into consideration especially.

[0137] If optical irradiation is carried out at this detached core 120, it will be excited photochemistry-wise [ the matter which constitutes a detached core 120 ], or thermally, combination of the molecule of the front face and interior or an atom will be cut, and this molecule or an atom will be emitted outside. It is desirable to secure the proof stress by the mechanical strength of the imprint object 180 so that the





stress which acts on the upper layer of a detached core 120 with discharge of this molecule or an atom may be caught with the imprint object 180. Thereby, it is because deformation or destruction of the upper layer of a detached core 120 is prevented.

[0138] What is necessary is just to secure such proof stress not only from what is secured only by the mechanical strength of the imprint object 180 but from the detached core 120 by the mechanical strength of any one or two or more layers of the layer 140 located in the upper layer, i.e., a transferred layer, a glue line 160, and the imprint object 180. In order to secure such proof stress, the quality of the material and thickness of the transferred layer 140, a glue line 160, and the imprint object 180 can be chosen suitably.

[0139] Only with the transferred layer 140, a glue line 160, and the imprint object 180, when the above-mentioned proof stress cannot be secured, as shown in drawing 35 (A) - (E), the reinforcement layer 132 can also be formed in one of the positions which serves as the upper layer from a detached core 120.

[0140] The reinforcement layer 132 shown in drawing 35 (A) is formed between the detached core 120 and the transferred layer 140. If it carries out like this, after producing exfoliation in a detached core 120 and making it secede from a substrate 100 after that, the reinforcement layer 132 is also removable from the transferred layer 140 with the detached core 120 which remains. Like drawing 35 (B), the reinforcement layer 132 prepared in the upper layer of the imprint object 180 is also removable from the imprint object 180, after producing exfoliation in a detached core 120 at least.

[0141] The reinforcement layer 132 shown in drawing 35 (C) intervenes as an insulating layer in two or more layers which constitute the transferred layer 140. Each reinforcement layer 132 of drawing 35 (D) and (E) is arranged at the lower layer or the upper layer of a glue line 140. Removing behind in these cases becomes impossible.

[0142] As a component of the imprint object 180, various synthetic resin or various glass material are mentioned, and especially, various synthetic resin and the usual cheap glass material (low melting point) are desirable, and can also determine thickness in consideration of the above-mentioned proof stress.

[0143] As synthetic resin, any of thermoplastics and thermosetting resin are sufficient. For example, polyethylene, a polypropylene, an ethylene-polyene copolymer, Polyolefines, such as an ethylene vinylacetate copolymer (EVA), an annular polyolefine, A denaturation polyolefine, a polyvinyl chloride, a polyvinylidene chloride, polystyrene, A polyamide, a polyimide, a polyamidoimide, a polycarbonate, Poly (4-methyl BENTEN -1), An ionomer, an acrylic resin, a polymethylmethacrylate, an acrylic-styrene copolymer (AS resin), A Butadiene Styrene, a polyimide copolymer (EVOH), a polyethylene terephthalate (PET), Polyester, such as poly (CHIREN terephthalate (PBT) and pulley cyclohexane terephthalate (PCT), A polyether, a polyether ketone (PEK), a polyether ether ketone (PEEK), Polyether imide, a polyacetal (POM), a polyphenylene oxide, A denaturation polyphenylene oxide, a polyarylate, an aromatic polyester (liquid crystal polymer), A polytetrafluoroethylene, a polyvinylidene fluoride, other fluorine system resins, A styrene system, a polyolefine system, a polyvinyl chloride system, a polyurethane system, Various thermoplastic elastomer, such as a fluororubber system and a chlorinated-polyethylene system, An EBOKISHI resin, phenol resin, a urea resin, melamine resin, a unsaturated polyester, The copolymer which is mainly concerned with these, a blend object, a polymer alloy, etc. are mentioned, and silicone resin, polyurethane, etc. can be used combining 1 of sorts of these, and two sorts or more (as a layered product for example, more than two-layer).

[0144] As glass material, silicic-acid glass (quartz glass), silicic-acid alkali glass, a soda lime glass, potash-lime glass, lead (alkali) glass, barium glass, borosilicate glass, etc. are mentioned, for example. Among these, compared with silicic-acid glass, the melting point is low, and fabrication and processing are also comparatively easy the melting point, and, moreover, things other than silicic-acid glass have it, and are desirable. [ cheap ]

[0145] When using what consisted of synthetic resin as an imprint object 180, while being able to fabricate the large-scale imprint object 180 in one, even if it is complicated configurations, such as what has a curve side and irregularity, it can manufacture easily, and the various advantages that material cost and a manufacturing cost are also cheap can be enjoyed. Therefore, use of synthetic resin is advantageous when manufacturing a large-sized and cheap device (for example, liquid crystal display).



[0146] In addition, the imprint object 180 may constitute a part of device like what constitutes the device which became independent in itself like a liquid crystal cell, a light filter and an electrode layer, a dielectric layer, an insulating layer, and a semiconductor device.

[0147] Furthermore, the imprint objects 180 may be matter, such as a metal, ceramics, a stone, and wood paper, and may be on the front face of the structures, such as a wall, a pillar, a ceiling, and a windowpane, further on the arbitrary fields which constitute a certain article (superiors of the front-face top of the field top of a clock, and an air-conditioner, and a printed circuit board).

[0148] As shown in [a process 4], next drawing 4, light is irradiated from the rear-face side of a substrate 100.

[0149] After this light penetrates a substrate 100, it is irradiated by the detached core 120. Thereby, the ablation in a layer and/or interfacial peeling arise in a detached core 120, and bonding strength decreases or disappears.

[0150] It is presumed that it is what is depended on phase changes, such as that ablation produces the principle which the ablation in a layer and/or interfacial peeling of a detached core 120 produce in the component of a detached core 120 and discharge of the gas contained in the detached core 120, melting further produced immediately after irradiation, and evapotranspiration.

[0151] Conditions, such as composition of a detached core 120, and a kind of light irradiated as one of the factor of the, wavelength, intensity, the attainment depth, are mentioned by in addition to this being influenced by various factors they are [ whether a detached core 120 produces the ablation in a layer, interfacial peeling is produced, or ] the both.

[0152] As a light to irradiate, if a detached core 120 is made to start the ablation in a layer, and/or interfacial peeling, what thing may be used, for example, an X-ray, ultraviolet rays, the light, infrared radiation (heat ray), a laser beam, a millimeter wave, microwave, an electron ray, radiation (alpha rays, beta rays, gamma ray), etc. will be mentioned. A laser beam is desirable at the point of being easy to produce ablation (ablation) of a detached core 120 also in it.

[0153] As laser equipment made to generate this laser beam, although various gas laser, solid state laser (semiconductor laser), etc. are mentioned, an excimer laser, Nd-YAG laser, Ar laser, a CO<sub>2</sub> laser, a CO laser, helium-Ne laser, etc. are used suitably, and especially an excimer laser is desirable also in it.

[0154] Since it outputs a high energy in a short wavelength region, extremely, an excimer laser can make a detached core 2 produce ablation for a short time, and it can exfoliate a detached core 120, without making the imprint object 180 and substrate 100 grade which therefore adjoin produce most temperature rises (i.e., without it producing degradation and an injury).

[0155] Moreover, when it makes it faced that a detached core 120 produces ablation and there is a wavelength dependency of light, as for the wavelength of the laser beam irradiated, it is desirable that it is 100nm - about 350nm.

[0156] An example of permeability to the wavelength of light of a substrate 100 is shown in drawing 7. It has the property that permeability increases steeply to the wavelength of 300nm so that it may be illustrated. In such a case, light (for example, Xe-Cl excimer laser light with a wavelength of 308nm) with a wavelength of 300nm or more is irradiated.

[0157] Moreover, when making a detached core 120 start phase changes, such as a gas evolution, evaporation, and sublimation, and giving a separation property to it, as for the wavelength of the laser beam irradiated, it is desirable that it is about 350 to 1200nm.

[0158] Moreover, as for especially the energy density in the case of an excimer laser, it is desirable the energy density of the laser beam irradiated and to consider as about two 10 - 5000 mJ/cm, and it is more desirable to consider as about two 100 - 1000 mJ/cm. Moreover, as for irradiation time, it is desirable to be referred to as about 1 - 1000ns, and it is more desirable to be referred to as about 10 - 100ns. When sufficient ablation etc. does not arise, and an energy density is high, when an energy density is low or irradiation time is short, or irradiation time is long, there is a possibility of having a bad influence on the transferred layer 140 by the irradiation light which penetrated the detached core 120.

[0159] Here, with the gestalt of this operation, since the detached core 120 is formed in the amorphous silicon layer of 10nm thickness, ablation can be caused in the amorphous silicon layer 120 by absorption



of a comparatively small light energy. Thus, the suitable method of making the amorphous silicon layer 120 absorb a comparatively small light energy is explained using drawing 32.

[0160] Drawing 32 makes a line beam scan intermittently, and shows the method of a detached core 120 which carries out optical irradiation mostly to the whole surface through the substrate 100. In each drawing, when the number of times which carried out the beam scan of the line beam is expressed with  $N$ , as the irradiation field 20 of the  $N$ th line beam ( $N$ ) and the irradiation field 20 ( $N+1$ ) of the  $N+1$ st line beams do not lap, the beam scan of each time is carried out. For this reason, between the adjacent irradiation field 20 ( $N$ ) and 20 ( $N+1$ ), the low irradiation field narrower enough than the irradiation field or the non-irradiating field 30 of each time is formed.

[0161] Here, if it continues carrying out outgoing radiation of the beam also at the time of the movement when moving the line beam 10 relatively to a substrate 100, the field of a sign 30 will turn into a low irradiation field. On the other hand, if it is made not to carry out outgoing radiation of the line beam 10 at the time of movement, the field of a sign 30 will turn into a non-irradiating field.

[0162] When the beam irradiation fields of each time are overlapped unlike the method of drawing 32, too much light more than the light made sufficient for producing ablation in the inside of the layer of a detached core 120 and/or an interface will be irradiated. If incidence is carried out to the transferred layer 140 which a part of too much of this light leaks, and contains a thin film device through a detached core 120, it will become the cause of deteriorating, the property, for example, electrical property, of the thin film device.

[0163] By the method of drawing 32, since such too much light is not irradiated by the detached core 120, after a thin film device is imprinted by the imprint object, the property of original of the thin film device is maintainable. In addition, although ablation does not arise in the detached core 120

corresponding to a low irradiation field or the non-irradiating field 30, the adhesion of a detached core 120 and a substrate 100 can fully be reduced by ablation in the beam irradiation field of the both sides.

[0164] In addition, as a cure in case the irradiation light which penetrated the detached core 120 reaches even the transferred layer 140 and does a bad influence, as shown in drawing 30, there is the method of forming the metal membranes 124, such as a tantalum (Ta), on a detached core (laser absorption layer) 120, for example. Thereby, it is completely reflected by the interface of a metal membrane 124, and the laser beam which penetrated the detached core 120 does not have a bad influence on the thin film device above it.

[0165] However, there is a possibility that metal contamination of the thin film device may be carried out though it is necessary to form a thin film device on it and the insulating layer of a silicon system is made to intervene between a metal membrane 124 and a thin film device like drawing 30, if a metal membrane 124 is formed.

[0166] Then, it is desirable to adopt a method as a method of replacing with drawing 30, as shown in drawing 33 and drawing 34.

[0167] Drawing 33 is the example which used the amorphous silicon layer 120 as a detached core, and has formed further the amorphous silicon layer 126 used for the lower layer of the transferred layer 140 as a silicon system optical-absorption layer. In order to separate these two amorphous silicon layers 120 and 126, the silicon oxide ( $\text{SiO}_2$ ) intervenes as a silicon system mediation layer.

[0168] If it carries out like this, even if irradiation light should penetrate the amorphous silicon layer 120 which is a detached core, the transmitted light will be absorbed by the amorphous silicon layer 126 as a silicon system optical-absorption layer. Consequently, it does not have a bad influence on the thin film device above it.

[0169] And since both two added layers 126, 128 are layers of a silicon system, metal contamination etc. is not caused as established in the conventional thin film coating technology.

[0170] In addition, rather than the thickness of the amorphous silicon layer 120 as a detached core, if thickness of the amorphous silicon layer 126 as an optical-absorption layer is thickened, a possibility that ablation may arise in the amorphous silicon layer 126 can be prevented certainly. However, since there are enough few light energies which carry out incidence not only to the relation of the above-mentioned thickness but to the amorphous silicon layer 126 than the light energy which carries out



direct incidence to the amorphous silicon layer 120 as a detached core, they can prevent that ablation arises in the amorphous silicon layer 126.

[0171] In addition, as shown in drawing 34, the example which formed the silicon system optical-absorption layer 130 of the different quality of the material from a detached core 120 does not need to be shown, and it is not necessary to necessarily form the silicon system intervention layer 128 in this case.

[0172] When it constitutes as drawing 33 and drawing 34 and the cure against optical leakage in a detached core 120 is performed, even if it is the case that the optical-absorption energy for exfoliation arising in a detached core 120 is large, there is an advantage which can prevent the bad influence to a thin film device certainly.

[0173] As for the irradiation light represented by the laser beam, it is desirable to irradiate so that the intensity may become uniform. The direction of radiation of irradiation light may be a direction which carried out the predetermined angle inclination not only to a perpendicular direction but to the detached core 120 to the detached core 120.

[0174] Next, the force is applied to a substrate 100 and this substrate 100 is made to secede from a detached core 120, as shown in drawing 5. Although not illustrated in drawing 5, a detached core may adhere on a substrate 100 after this secession.

[0175] Next, as shown in drawing 6, the extant detached core 120 is removed by the method which combined methods, such as washing, etching, ashing, and polish, or these. It means that the transferred layer (thin film device layer) 140 had been imprinted by the imprint object 180 by this.

[0176] In addition, when a part of detached core has adhered also to the substrate 100 from which it seceded, it removes similarly. In addition, when the substrate 100 consists of an expensive material like quartz glass, and a rare material, reuse (recycling) is preferably presented with a substrate 100. That is, this invention can be applied to the substrate 100 to reuse, and usefulness is high.

[0177] The imprint to the imprint object 180 of the transferred layer (thin film device layer) 140 is completed through each above process. Then, conductive layers, such as removal of SiO<sub>2</sub> film which adjoins the transferred layer (thin film device layer) 140, and wiring of a up to [ the transferred layer 140 ], formation of a desired protective coat, etc. can also be performed.

[0178] In this invention, transferred layer (thin film device layer) 140 the very thing which is an exfoliated object is not exfoliated directly. Since it exfoliates in the detached core joined to the transferred layer (thin film device layer) 140, Irrespective of the property of an exfoliated object (transferred layer 140), conditions, etc., it can exfoliate easily and uniformly certain moreover (imprint), there is also no damage to the exfoliated object (transferred layer 140) in accordance with exfoliation operation, and the high reliability of the transferred layer 140 can be maintained.

[0179] (Form of the 2nd operation) TFT of CMOS structure is formed on a substrate and the example of the concrete manufacture process in the case of imprinting this on an imprint object is explained using drawing 8 - drawing 18.

[0180] (Process 1) As shown in drawing 8, the amorphous silicon layer 120 formed by the LPCVD method as a detached core on the substrate (for example, quartz substrate) 100 is formed. The thickness of this amorphous silicon layer 120 is 10nm. Moreover, laminating formation of an interlayer (for example, SiO<sub>2</sub> film) 142 and the amorphous silicon layer (for example, formed by the LPCVD method) 143 is carried out one by one, then a laser beam is irradiated from the upper part all over the amorphous silicon layer 143, and annealing is given. Thereby, the amorphous silicon layer 143 is recrystallized and turns into a polysilicon contest layer. Here, as shown in drawing 33, the silicon system intervention layer 128, for example, a silicon oxide, and another amorphous silicon layer 126 for optical absorptions can also be formed among the amorphous silicon layers 120 and interlayers 142 who turn into a detached core.

[0181] (Process 2) Then, as shown in drawing 9, patterning of the polysilicon contest layer obtained by laser annealing is carried out, and Islands 144a and 144b are formed.

[0182] (Process 3) As shown in drawing 10, the wrap gate insulator layers 148a and 148b are formed for Islands 144a and 144b by CVD.

[0183] (Process 4) As shown in drawing 11, the gate electrodes 150a and 150b which consist of contest





polysilicon or metal are formed.

[0184] (Process 5) As shown in drawing 12 , the mask layer 170 which consists of a polyimide etc. is formed, using gate electrode 150b and the mask layer 170 as a mask, it is a self aryne, for example, the ion implantation of boron (B) is performed. Of this, the p+ layers 172a and 172b are formed.

[0185] (Process 6) As shown in drawing 13 , the mask layer 174 which consists of a polyimide etc. is formed, using gate electrode 150a and the mask layer 174 as a mask, it is a self aryne, for example, the ion implantation of Lynn (P) is performed. Of this, the n+ layers 146a and 146b are formed.

[0186] (Process 7) As shown in drawing 14 , the layer insulation film 154 is formed and Electrodes 152a-152d are alternatively formed after contact hole formation.

[0187] Thus, TFT of the formed CMOS structure corresponds to the transferred layer (thin film device layer) 140 in drawing 2 - drawing 6 . In addition, you may form a protective coat on the layer insulation film 154.

[0188] (Process 8) As shown in drawing 15 , the epoxy resin layer 160 as a glue line is formed on TFT of CMOS composition, next TFT is stuck on the imprint object (for example, soda-glass substrate) 180 through the epoxy resin layer 160. Then, heat is applied, an epoxy resin is stiffened and the imprint object 180 and TFT are pasted up (junction).

[0189] In addition, the photopolymer resin which is ultraviolet-rays hardening type adhesives is sufficient as a glue line 160. In this case, ultraviolet rays are irradiated from the imprint object [ not heat but ] 180 side, and polymer is stiffened.

[0190] (Process 9) As shown in drawing 16 , Xe-Cl excimer laser light is irradiated with the beam scan of drawing 32 from the rear face of a substrate 100, for example. This produces and cheats out of exfoliation in the inside of the layer of a detached core 120, and/or an interface. Since the thickness of the amorphous silicon layer 120 which is a detached core was 10nm at this time, the light energy for producing exfoliation has been reduced enough. moreover -- although stress acts on upper each class 142, 154, 160, and 180 rather than the amorphous silicon layer 120 in the case of exfoliation of the amorphous silicon layer 120 -- this stress -- the upper layer -- 142, 154, 160, and 180 -- therefore it is caught and deformation and destruction of a thin film device are prevented

[0191] (Process 10) A substrate 100 is torn off as shown in drawing 17 .

[0192] (Process 11) Finally etching removes a detached core 120. It means that TFT of CMOS composition had been imprinted by the imprint object 180 by this as shown in drawing 18 . In addition, as shown in drawing 33 , when the silicon system intervention layer 128, for example, a silicon oxide, and another amorphous silicon layer 126 for optical absorptions are formed on the detached core 120, the following two processes can also be added before the etching removal process of a detached core 120. One of them is a process which removes the amorphous silicon layer 126 which is an optical-absorption layer in dry etching, and other one is a process which removes the silicon oxide 128 by fluorine acid etc.

[0193] (Form of the 3rd operation) if the technology explained with the form of the 1st operation of a \*\*\*\* and the form of the 2nd operation is used, the microcomputer constituted using the thin film device as shown in drawing 19 (a), for example can be formed on the substrate which is a request

[0194] In drawing 19 (a), the solar battery 340 possessing the PIN junction of an amorphous silicon for supplying the supply voltage of these circuits to CPU300, RAM320, and the I/O circuit 360 row from which the thin film device was used and which the circuit consisted of is carried on the flexible substrate 182 which consists of plastics etc.

[0195] Since the microcomputer of drawing 19 (a) is formed on the flexible substrate, as shown in drawing 19 (b), since it is lightweight, it has strongly the feature that it is strong also to fall in bending.

[0196] (Form of the 4th operation) the form of this operation explains the example which is a manufacture process in the case of creating the active-matrix type liquid crystal display using the active-matrix substrate as shown in drawing 20 and drawing 21 using the imprint technology of an above-mentioned thin film device

[0197] (Composition of a liquid crystal display) As shown in drawing 20 , an active-matrix type liquid crystal display possesses the lighting light sources 400, such as a back light, a polarizing plate 420, the



active-matrix substrate 440, liquid crystal 460, the opposite substrate 480, and a polarizing plate 500.

[0198] In addition, if it constitutes as a reflected type liquid crystal panel which replaced with the lighting light source 400 and adopted the reflecting plate when using a flexible substrate like plastic film for the active-matrix substrate 440 and the opposite substrate 480 of this invention, there is flexibility and a lightweight active matrix liquid crystal panel strong against a shock and can be realized. In addition, when a pixel electrode is formed with a metal, a reflecting plate and a polarizing plate 420 become unnecessary.

[0199] The active-matrix substrate 440 used with the form of this operation arranges TFT in the pixel section 442, and is a driver built-in active-matrix substrate in which the driver circuit (a scanning-line driver and data-line driver) 444 was carried further.

[0200] The cross section of the important section of this active matrix liquid crystal display is shown in drawing 21 , and the circuitry of the important section of a liquid crystal display is shown in drawing 22 .

[0201] As shown in drawing 22 , the gate is connected to the gate line G1, one side of a source drain is connected to the data line D1, and the pixel section 442 contains TFT (M1) by which another side of a source drain was connected to liquid crystal 460, and liquid crystal 460.

[0202] Moreover, the driver section 444 is constituted including TFT (M2) formed of the same process as TFT (M1) of the pixel section.

[0203] As shown in the left-hand side of drawing 21 , TFT (M1) in the pixel section 442 is constituted including the source drain layers 1100a and 1100b, channel 1100e, gate insulator layer 1200a, gate electrode 1300a, an insulator layer 1500, and the source drain electrodes 1400a and 1400b.

[0204] In addition, a reference number 1700 is a pixel electrode and a reference number 1702 shows the field (voltage impression field to liquid crystal) where the pixel electrode 1700 impresses voltage to liquid crystal 460. The orientation film is omitted among drawing. The pixel electrode 1700 is constituted by metals (in the case of a reflected type liquid crystal panel), such as ITO (in the case of a light-transmission type liquid crystal panel), or aluminum. Moreover, in drawing 21 , in the voltage impression field 1702 to liquid crystal, although the ground insulator layer 1000 under the pixel electrode 1700 (interlayer) is removed completely, it is not necessarily limited to this, and since the ground insulator layer (interlayer) 1000 is thin, when not becoming the hindrance of the voltage impression to liquid crystal, you may leave.

[0205] Moreover, as shown in the right-hand side of drawing 21 , TFT (M2) which constitutes the driver section 444 is constituted including the source, the drain layers 1100c and 1100d, channel 1100f, gate insulator layer 1200b, gate electrode 1300b, an insulator layer 1500, and the source drain electrodes 1400c and 1400d.

[0206] In addition, in drawing 21 , a reference number 480 is for example, an opposite substrate (for example, soda-glass substrate), and a reference number 482 is a common electrode. Moreover, a reference number 1000 is SiO<sub>2</sub> film, a reference number 1600 is a layer insulation film (for example, SiO<sub>2</sub> film), and a reference number 1800 is a glue line. Moreover, a reference number 1900 is a substrate (imprint object) which consists for example, of a soda-glass substrate.

[0207] (Manufacture process of a liquid crystal display) The manufacture process of the liquid crystal display of drawing 21 is hereafter explained with reference to drawing 23 - drawing 27 .

[0208] First, it forms through the same manufacture process as drawing 8 - drawing 18 on the substrate (for example, quartz substrate) 3000 which it is reliable in TFT (M1, M2) like drawing 23 , and penetrates a laser beam, and a protective coat 1600 is constituted. In addition, in drawing 23 , a reference number 3100 is a detached core (laser absorption layer). Moreover, in drawing 23 , both TFT (M1, M2) is taken as n type MOSFET. However, it is good also as not the thing limited to this but p type MOSFET, and CMOS structure.

[0209] Next, as shown in drawing 24 , a protective coat 1600 and the ground insulator layer 1000 are \*\*\*\*\*ed alternatively, and openings 4000 and 4200 are formed alternatively. These two openings are simultaneously formed using a common etching process. In addition, in drawing 24 , when it is not necessarily limited to this, and not becoming the hindrance of the voltage impression to liquid crystal in



opening 4200 since the ground insulator layer (interlayer) 1000 is thin although the ground insulator layer (interlayer) 1000 is removed completely, you may leave.

[0210] Next, as shown in drawing 25, the pixel electrode 1700 which consists of metals, such as an ITO film or aluminum, is formed. In using an ITO film, it becomes a penetrated type liquid crystal panel, and in using metals, such as aluminum, it becomes a reflected type liquid crystal panel. Next, as shown in drawing 26, a substrate 1900 is joined through a glue line 1800 (adhesion).

[0211] Next, as shown in drawing 26, excimer laser light is irradiated from the rear face of a substrate 3000, and a substrate 3000 is torn off after this.

[0212] Next, a detached core (laser absorption layer) 3100 is removed. Thereby, the active-matrix substrate 440 as shown in drawing 27 is completed. It has exposed and the electric connection with liquid crystal is possible for the base (field of a reference number 1702) of the pixel electrode 1700. Then, an orientation film is formed in the front face of the insulator layer (interlayers, such as SiO<sub>2</sub>) 1000 of the active-matrix substrate 440, and pixel electrode 1702 front face, and orientation processing is performed. The orientation film is omitted in drawing 27.

[0213] And the pixel electrode 1709 and the common electrode which counters are further formed in the front face, the opposite substrate 480 and the acouchi boomer TORIKU substrate 440 of drawing 21 by which orientation processing of the front face was carried out are closed with a sealing agent (sealant), liquid crystal is enclosed among both substrates, and a liquid crystal display as shown in drawing 21 is completed.

[0214] (Form of the 5th operation) The form of operation of the 5th of this invention is shown in drawing 28.

[0215] With the form of this operation, multiple-times execution of the imprint method of an above-mentioned thin film device is carried out, on a larger substrate (imprint object) than the substrate of an imprinting agency, two or more patterns containing a thin film device are imprinted, and, finally a large-scale active-matrix substrate is formed.

[0216] That is, on the big substrate 7000, the imprint of multiple times is performed and the pixel sections 7100a-7100p are formed. TFT and wiring are formed in the pixel section as surrounded and shown to the drawing 28 bottom by the alternate long and short dash line. In drawing 28, a reference number 7200 is a signal line, a reference number 7210 is the scanning line and a reference number 7230 is [ a reference number 7220 is a gate electrode and ] a pixel electrode.

[0217] The large-scale active-matrix substrate in which the reliable thin film device was carried can be created by repeating and using a reliable substrate or carrying out multiple-times execution of the imprint of a thin film pattern using two or more 1st substrates.

[0218] (Form of the 6th operation) The form of operation of the 6th of this invention is shown in drawing 29.

[0219] The feature of the form of this operation is imprinting two or more patterns containing the thin film device (thin film device from which it is got blocked and a minimum line width's differs) from which multiple-times execution of the imprint method of an above-mentioned thin film device is carried out, and a design rule's (that is, design rule's when carrying out a pattern design's) differs on a bigger substrate than the substrate top of an imprinting agency.

[0220] In drawing 29, the driver circuit (8000-8032) created in the more detailed manufacture process rather than the pixel section (7100a-7100p) is created around the substrate 6000 by the imprint of multiple times in the active-matrix substrate of driver loading.

[0221] Since the shift register which constitutes a driver circuit carries out operation of logic level to the bottom of a low battery, from Pixel TFT, pressure-proofing may be low, and as it is therefore set to TFT more detailed than Pixel TFT, high integration can be attained.

[0222] According to the form of this operation, two or more circuits where design rule level differs (that is, manufacture processes differ) are realizable on one substrate. In addition, since high pressure-proofing is required for a sampling means (TFT M2 of drawing 22) to sample a data signal by control of a shift register, like Pixel TFT, it is good to form with the same process as Pixel TFT / same design rule.



[0223]

[Example] Next, the concrete example of this invention is explained.

[0224] (Example 1) The quartz substrate (softening temperature : 1630 degrees C, a strain point : 1070 degrees C, permeability of an excimer laser : almost 100%) with a 50mm[ 50mm by ] x thickness of 1.1mm was prepared, and the amorphous silicon (a-Si) film was formed in one side of this quartz substrate by low voltage CVD (Si<sub>2</sub> H<sub>6</sub> gas, 425 degrees C) as a detached core (laser beam absorption layer). As thickness of a detached core, two kinds of things, 10nm and 100nm, were formed.

[0225] Next, it is SiO<sub>2</sub> as an interlayer on a detached core. The film was formed by efficient consumer response-CVD (SiH<sub>4</sub>+O<sub>2</sub> gas, 100 degrees C). An interlayer's thickness was 200nm.

[0226] Next, the amorphous silicon film of 50nm of thickness was formed by low voltage CVD (Si<sub>2</sub> H<sub>6</sub> gas, 425 degrees C) as a transferred layer on the interlayer, a laser beam (wavelength of 308nm) is irradiated, this amorphous silicon film was crystallized, and it considered as the polysilicon contest film. Then, to this polysilicon contest film, predetermined patterning was performed and the field used as the source drain channel of TFT was formed. then, the elevated temperature more than 1000 degreeC -- a polysilicon contest film front face -- oxidizing thermally -- gate insulator layer SiO<sub>2</sub> after forming, form a gate electrode (structure where laminating formation of the refractory metals, such as Mo, was carried out at contest polysilicon), on a gate insulator layer, and it carries out an ion implantation, using a gate electrode as a mask -- self -- being conformable (selfer line) -- the source drain field was formed and TFT was formed Then, the electrode connected to a source drain field and wiring, and the wiring which leads to a gate electrode are formed if needed. Although aluminum is used for these electrodes and wiring, it is not limited to this. Moreover, when worrying about melting of aluminum by the laser radiation of a back process, you may use the metal (what is not fused by the laser radiation of a back process) of a high-melting point rather than aluminum.

[0227] Next, ultraviolet-rays hardening type adhesives were applied on the aforementioned TFT (thickness : 100 micrometers), further, after joining a transparent large-sized glass substrate (a soda glass, softening temperature:740 degree C, strain-point:511 degree C) with a 300mm[ 200mm by ] x thickness of 1.1mm to the paint film as an imprint object, ultraviolet rays were irradiated from the glass-substrate side, adhesives were stiffened, and adhesion fixation of these was carried out.

[0228] Next, the Xe-Cl excimer laser (wavelength : 308nm) was irradiated from the quartz substrate side, and the detached core was made to produce exfoliation (exfoliation in a layer, and interfacial peeling). The energy density of the irradiated Xe-Cl excimer laser was 300 mJ/cm<sup>2</sup>, and irradiation time was 20ns. in addition, a unit field (for example, 8mmx8mm) predetermined when irradiation of an excimer laser has spot beam irradiation and line beam irradiation and it is spot beam irradiation -- spot irradiation -- carrying out -- this spot irradiation -- a unit field -- it irradiates with staggering about [ every ] 1/10 Moreover, in line beam irradiation, similarly, the predetermined unit field (for example, 378mmx0.1mm and 378mmx0.3mm (field where, as for these, 90% or more of energy is acquired)) is irradiated with staggering about [ every ] 1/10. Thereby, each point of a detached core receives at least ten irradiation. This laser radiation is carried out to the whole quartz substrate surface, shifting an irradiation field. The above method is effective, when setting thickness of a detached core to 100nm and making [ many ] light-energy absorption for ablation. When thickness of a detached core is set to 10nm, even if it makes it not pile up mutually two beam irradiation fields (for example, two beam irradiation fields (20 (N) of drawing 32 , and 20 (N+1))) which adjoin each other with a beam scan like drawing 32 , ablation can be produced and, moreover, the bad influence to a thin film device can be reduced. In addition, it was not destroyed by the total proof stress of each class of the upper layer of a detached core at this time that a thin film device deforms, either.

[0229] Then, the quartz substrate and the glass substrate (imprint object) were torn off in the detached core, and the TFT and the interlayer who were formed on the quartz substrate were imprinted to the glass-substrate side.

[0230] Then, etching, washing, or those combination removed the detached core adhering to the front face of the interlayer by the side of a glass substrate. Moreover, processing with the same said of a quartz substrate was performed, and the reuse was presented.





[0231] In addition, if the glass substrate used as an imprint object is a bigger substrate than a quartz substrate, the imprint to a glass substrate from a quartz substrate like this example can be repeatedly carried out to a superficially different field, and much TFT can be formed on a glass substrate from the number of the TFT which can be formed in a quartz substrate. Furthermore, on a glass substrate, a laminating can be carried out repeatedly and more TFT can be formed similarly.

[0232] (Example 2) a detached core -- H (hydrogen) -- 20at(s)% -- TFT was imprinted like the example 1 except having considered as the amorphous silicon film to contain

[0233] In addition, adjustment of the amount of H in an amorphous silicon film was performed by setting up suitably the conditions at the time of membrane formation by low voltage CVD.

[0234] (Example 3) TFT was imprinted like the example 1 except having made the detached core into the ceramic thin film (composition:  $\text{BaTiO}_3$ , thickness: 200nm) formed with the sol-gel method with the spin coat.

[0235] (Example 4) TFT was imprinted like the example 1 except having made the detached core into the ceramic thin film (composition:  $\text{BaTiO}_3$ , thickness: 400nm) formed by sputtering.

[0236] (Example 5) TFT was imprinted like the example 1 except having made the detached core into the ceramic thin film (composition:  $\text{Pb}(\text{Zr}, \text{Ti})\text{O}_3$  (PZT) and thickness: 50nm) formed by the laser-ablation method.

[0237] (Example 6) TFT was imprinted like the example 1 except having used the detached core as the polyimide film (thickness: 200nm) formed with the spin coat.

[0238] (Example 7) TFT was imprinted like the example 1 except having used the detached core as the polyphenylene sulfide film (thickness: 200nm) formed with the spin coat.

[0239] (Example 8) TFT was imprinted like the example 1 except having used the detached core as aluminum layer (thickness: 300nm) formed by sputtering.

[0240] (Example 9) As an irradiation light, TFT was imprinted like the example 2 except having used the Kr-F excimer laser (wavelength: 248nm). In addition, the energy density of the irradiated laser was 250 mJ/cm<sup>2</sup>, and irradiation time was 20ns.

[0241] (Example 10) As an irradiation light, TFT was imprinted like the example 2 except having used Nd-YAIG laser (wavelength: 1068nm). In addition, the energy density of the irradiated laser was 400 mJ/cm<sup>2</sup>, and irradiation time was 20ns.

[0242] (Example 11) TFT was imprinted like the example 1 except having considered as the TFT of the polysilicon contact film (80nm of thickness) by elevated-temperature process 1000 degree C as a transferred layer.

[0243] (Example 12) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 1 except having used the transparent substrate made from a polycarbonate (glass transition point: 130 degrees C).

[0244] (Example 13) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 2 except having used the transparent substrate made of an AS resin (glass transition point: 70-90 degrees C).

[0245] (Example 14) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 3 except having used the transparent substrate made from a polymethylmethacrylate (glass transition point: 70-90 degrees C).

[0246] (Example 15) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 5 except having used the transparent substrate made from a polyethylene terephthalate (glass transition point: 67 degrees C).

[0247] (Example 16) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 6 except having used the transparent substrate made from a high density polyethylene (glass transition point: 77-90 degrees C).

(Example 17) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 9 except having used the transparent substrate made from a polyamide (glass transition point: 145 degrees C).

[0248] (Example 18) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 10 except having used the transparent substrate made of an epoxy resin (glass transition point: 120 degrees C).

[0249] (Example 19) As an imprint object, TFT was imprinted like the example 11 except having used the transparent substrate made from a polymethylmethacrylate (glass transition point: 70-90 degrees C).

[0250] About examples 1-19, when the state of the imprinted TFT was guessed the \*\* view under the



naked eye and the microscope, respectively, all had neither a defect nor nonuniformity and the imprint was made uniformly.

[0251] Like, if the imprint technology of this invention is used, the thing which were described above and for which a thin film device (transferred layer) is imprinted to various imprint objects will become possible. or [ for example, / that a thin film cannot be formed directly ] -- or it can be formed by imprint also to what consisted of material unsuitable for forming, material with easy fabrication, a cheap material, etc., the large-sized body which is hard to move

[0252] That in which properties, such as thermal resistance and corrosion resistance, are inferior compared with various synthetic resin or substrate material like the low glass material of the melting point can be used especially for an imprint object. therefore -- for example, it can face manufacturing the liquid crystal display in which TFT (especially the polysilicon contest TFT) was formed on the transparent substrate, and a large-sized and cheap liquid crystal display can be easily manufactured now as an imprint object as a substrate using the quartz-glass substrate which is excellent in thermal resistance by using a transparent substrate of the material which it is cheap and processing tends to carry out like the low glass material of various synthetic resin or the melting point Such an advantage is the same also about manufacture of not only a liquid crystal display but other devices.

[0253] Moreover, although the above advantages are enjoyed, since a transferred layer like a functional thin film can be formed to a heat-resistant high substrate like a reliable substrate, especially a quartz-glass substrate and patterning can be carried out further, a reliable functional thin film can be formed on an imprint object irrespective of the material property of an imprint object.

[0254] Moreover, although such a reliable substrate is expensive, it is also possible to reuse it and, therefore, a manufacturing cost is also reduced.

[0255]

---

[Translation done.]

